



Низкие динамические потери
 Малый заряд обратного восстановления
 Разветвленный управляющий электрод для
 высоких скоростей нарастания тока

Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ573-2000-12

Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	I_{TAV}	2000 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	1000...1200 В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}	
Время выключения	t_q	10.0, 12.5, 16.0, 20.0 мкс
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	1000	1200
Класс по напряжению	10	12
$T_j, °C$	-60...+125	

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	А	2000 2376 3644	$T_c=92 °C$; двухстороннее охлаждение; $T_c=85 °C$; двухстороннее охлаждение; $T_c=55 °C$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	А	3140	$T_c=92 °C$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	65.0 75.0	$T_j=T_{jmax}$ $T_j=25 °C$	180 эл. град. синус; $t_p=10$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			68.0 78.0	$T_j=T_{jmax}$ $T_j=25 °C$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
I^2t	Защитный показатель	A^2c10^3	21100 28100	$T_j=T_{jmax}$ $T_j=25 °C$	180 эл. град. синус; $t_p=10$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			19100 25200	$T_j=T_{jmax}$ $T_j=25 °C$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1000...1200	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1100...1300	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\ max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	А	10	$T_j = T_{j\ max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	$T_j = T_{j\ max}$ для постоянного тока управления
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	А/мкс	2500	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 4000$ А; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 2$ А/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°С	-60...+50	
T_j	Температура р-п перехода	°С	-60...+125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	40.0...50.0	
a	Ускорение	м/с ²	50	В зажатом состоянии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии				
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.15	$T_j = 25$ °С; $I_{TM} = 6280$ А
$U_{T(ТО)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.456	$T_j = T_{j\ max}$; $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.090	
I_H	Ток удержания, макс	мА	1000	$T_j = 25$ °С; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики				
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	300	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ¹⁾ , мин	В/мкс	200, 320, 500, 1000, 1600, 2000, 2500	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

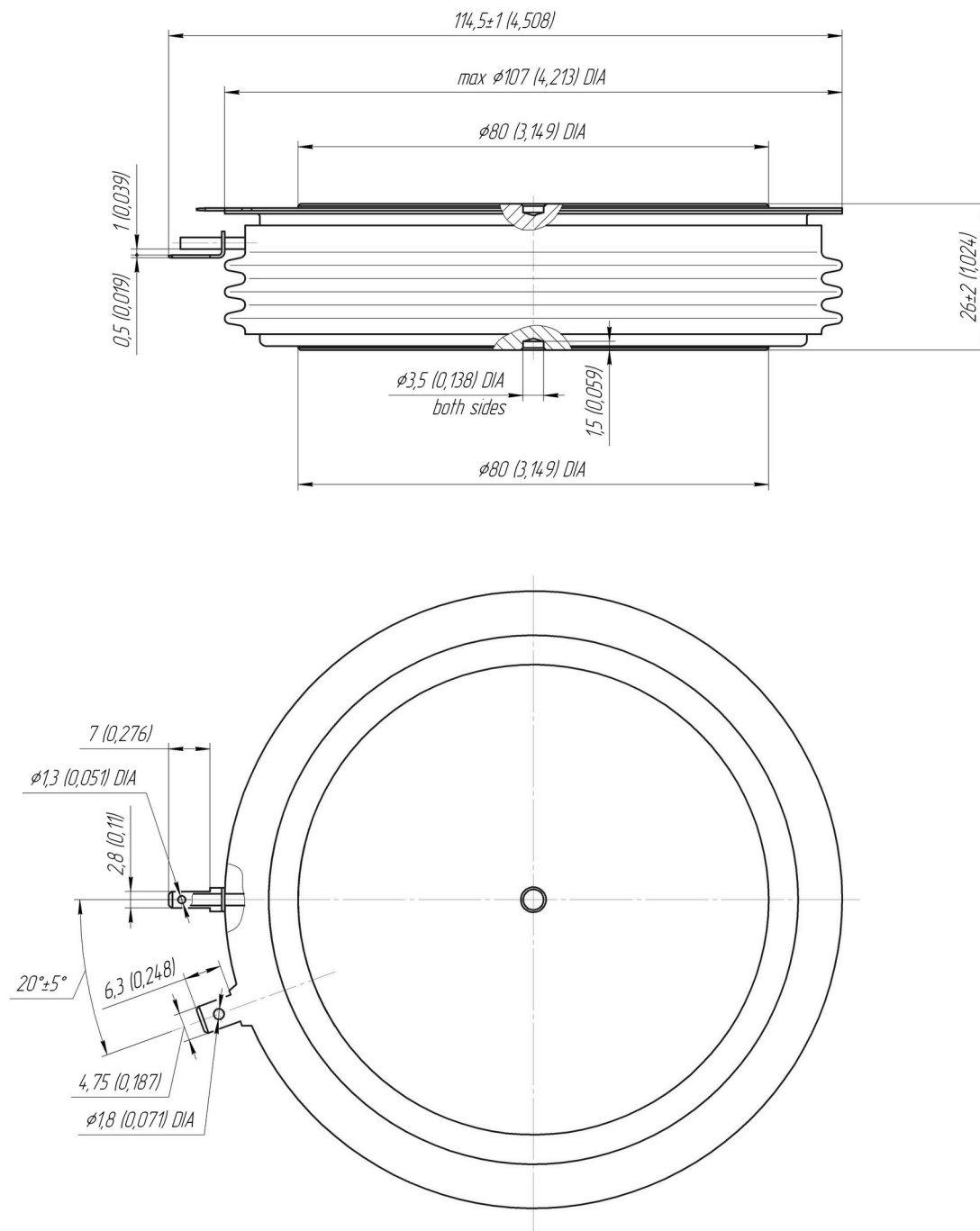
Характеристики управления					
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	3.00 3.00 1.50	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 \text{ В}; I_D = 3 \text{ А};$ Постоянный ток управления
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	500 300 150	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.35	$T_j = T_{j \max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$	Постоянный ток управления
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	65.00		

Динамические характеристики					
t_{gd}	Время задержки включения, макс	мкс	0.80	$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}; U_D = 600 \text{ В}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di/dt = 200 \text{ А/мкс};$	
t_{gt}	Время включения ²⁾ , макс	мкс	1.60, 2.00, 2.50, 3.20	Импульс управления: $I_G = 2 \text{ А}; U_G = 20 \text{ В};$ $t_{GP} = 50 \text{ мкс}; di_G/dt = 2 \text{ А/мкс}$	
t_q	Время выключения ³⁾ , макс	мкс	10.0, 12.5, 16.0, 20.0	$du_D/dt = 50 \text{ В/мкс};$	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -10 \text{ А/мкс};$ $U_R = 100 \text{ В};$ $U_D = 0.67 U_{DRM}$
			12.5, 16.0, 20.0, 25.0	$du_D/dt = 200 \text{ В/мкс};$	
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	220	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = 1000 \text{ А};$ $di_R/dt = -50 \text{ А/мкс};$ $U_R = 100 \text{ В}$	
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	3.8		
I_{rr}	Обратный ток восстановления, макс	А	115		

Тепловые характеристики					
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^\circ\text{C/Вт}$	0.0085	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R_{thjc-A}			0.0187		Охлаждение со стороны анода
R_{thjc-K}			0.0153		Охлаждение со стороны катода
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	$^\circ\text{C/Вт}$	0.0020	Постоянный ток	

Механические характеристики					
m	Масса, макс	г	1200		
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	27.37 (1.077)		
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	16.00 (0.629)		

МАРКИРОВКА								ПРИМЕЧАНИЕ										
ТБИ	573	2000	12	A2	P3	K4	УХЛ2	1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии										
1	2	3	4	5	6	7	8	Обозначение группы		P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1		
1. Быстродействующий импульсный тиристор								$(du_D/dt)_{crit}, \text{ В/мкс}$		200	320	500	1000	1600	2000	2500		
2. Конструктивное исполнение								Обозначение группы		T4	P4	M4	K4					
3. Средний ток в открытом состоянии, А								$t_{gt}, \text{ мкс}$		1.60	2.00	2.50	3.20					
4. Класс по напряжению								3) Время выключения ($du_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$)										
5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии								Обозначение группы		A4	X3	T3	P3					
6. Группа по времени выключения ($du_D/dt = 50 \text{ В/мкс}$)								$t_q, \text{ мкс}$		10.0	12.5	16.0	20.0					
7. Группа по времени включения																		
8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2																		



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.

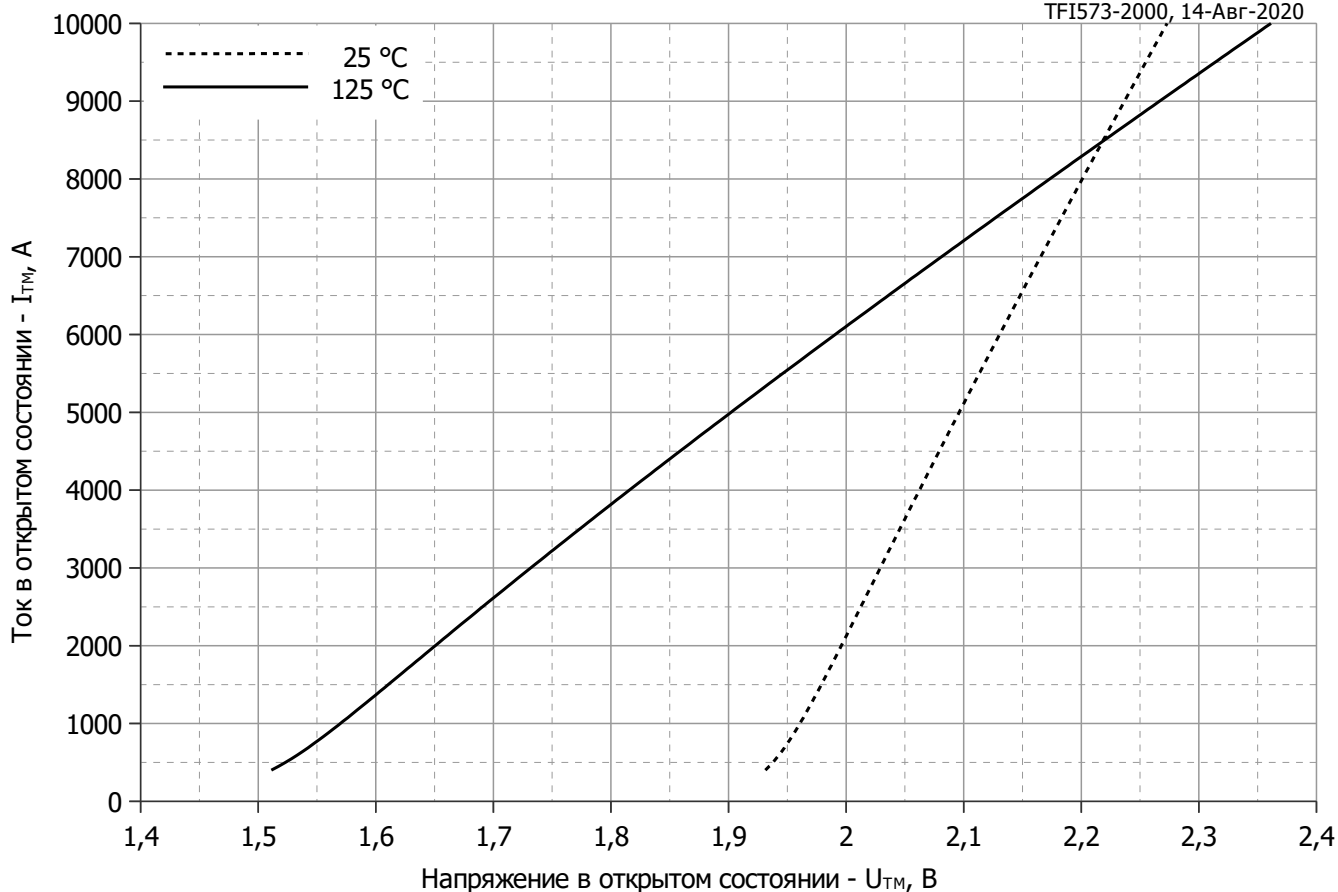


Рис. 1 – Вольт - амперная характеристика в открытом состоянии

Аналитическая функция вольт — амперной характеристики в открытом состоянии:

$$V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$$

	Коэффициенты для графика	
	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$T_j = T_{j \max}$
A	1.73646378	1.15209372
B	0.00004772	0.00012450
C	0.03947643	0.07620628
D	-0.00304265	-0.00737623

Вольт-амперная характеристика в открытом состоянии (см. Рис. 1).

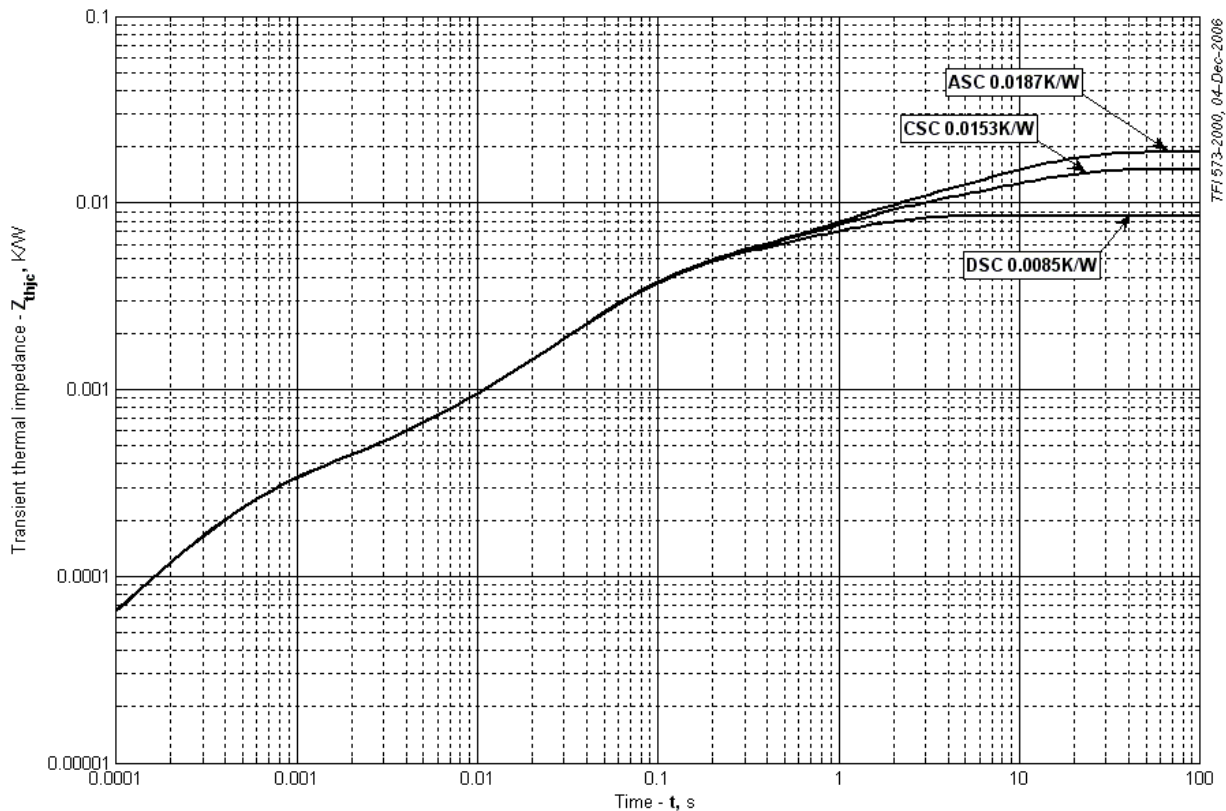


Рис. 2 – Переходное тепловое сопротивление

Аналитическая зависимость переходного теплового сопротивления переход — корпус:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n R_i \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Где $i = 1$ to n , n – число суммирующихся элементов.

t = продолжительность импульсного нагрева в секундах.

Z_{thjc} = Тепловое сопротивление за время t .

R_i, τ_i = расчетные коэффициенты, приведенные в таблице.

Постоянный ток, двустороннее охлаждение

i	1	2	3	4	5	6
$R_i, K/W$	0.0003136	0.003279	0.0001485	0.0007865	0.0002694	0.003703
τ_i, s	1.181	0.06771	0.003331	0.145	0.0004353	0.9499

Постоянный ток, охлаждение со стороны анода

i	1	2	3	4	5	6
$R_i, K/W$	0.01013	0.004062	0.0009701	0.00306	0.000148	0.0002685
τ_i, s	9.747	1.058	0.1302	0.06675	0.003276	0.0004342

Постоянный ток, охлаждение со стороны катода

i	1	2	3	4	5	6
$R_i, K/W$	0.006619	0.004032	0.0008219	0.003231	0.000147	0.0002716
τ_i, s	9.745	1.026	0.143	0.06778	0.00342	0.0004396

Модель переходного теплового сопротивления переход - корпус (см. Рис. 2)

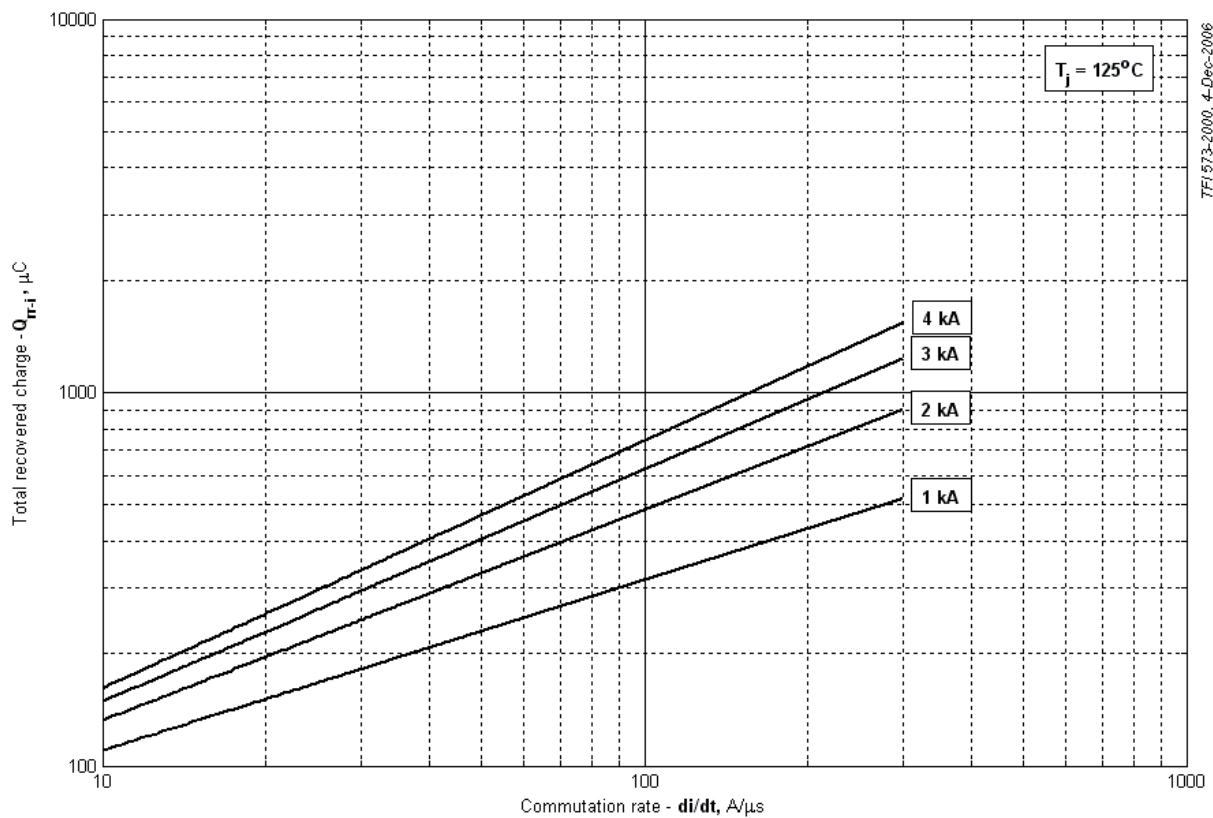


Рис. 3 – Максимальный интегральный заряд обратного восстановления, Q_{rr-i}

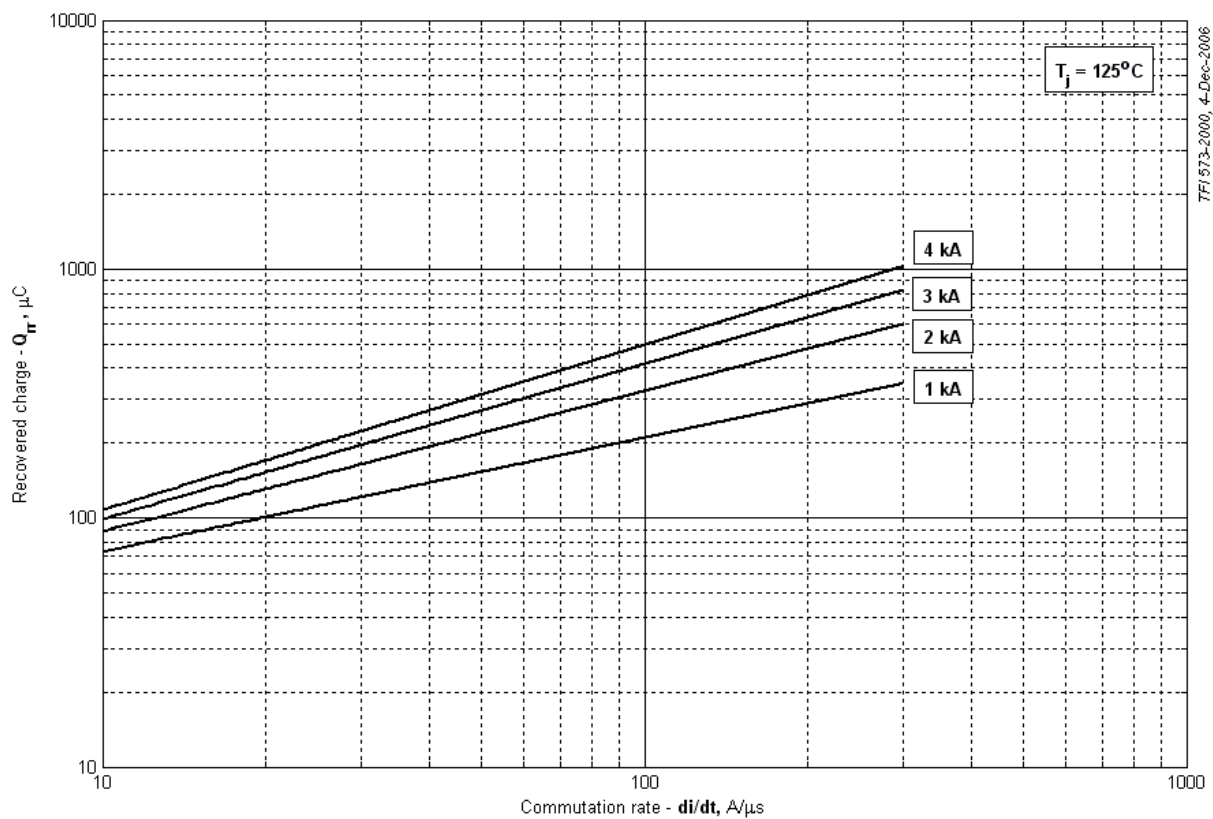


Рис. 4 – Максимальный заряд обратного восстановления, Q_{rr} (по ГОСТ 24461, хорда 25%)

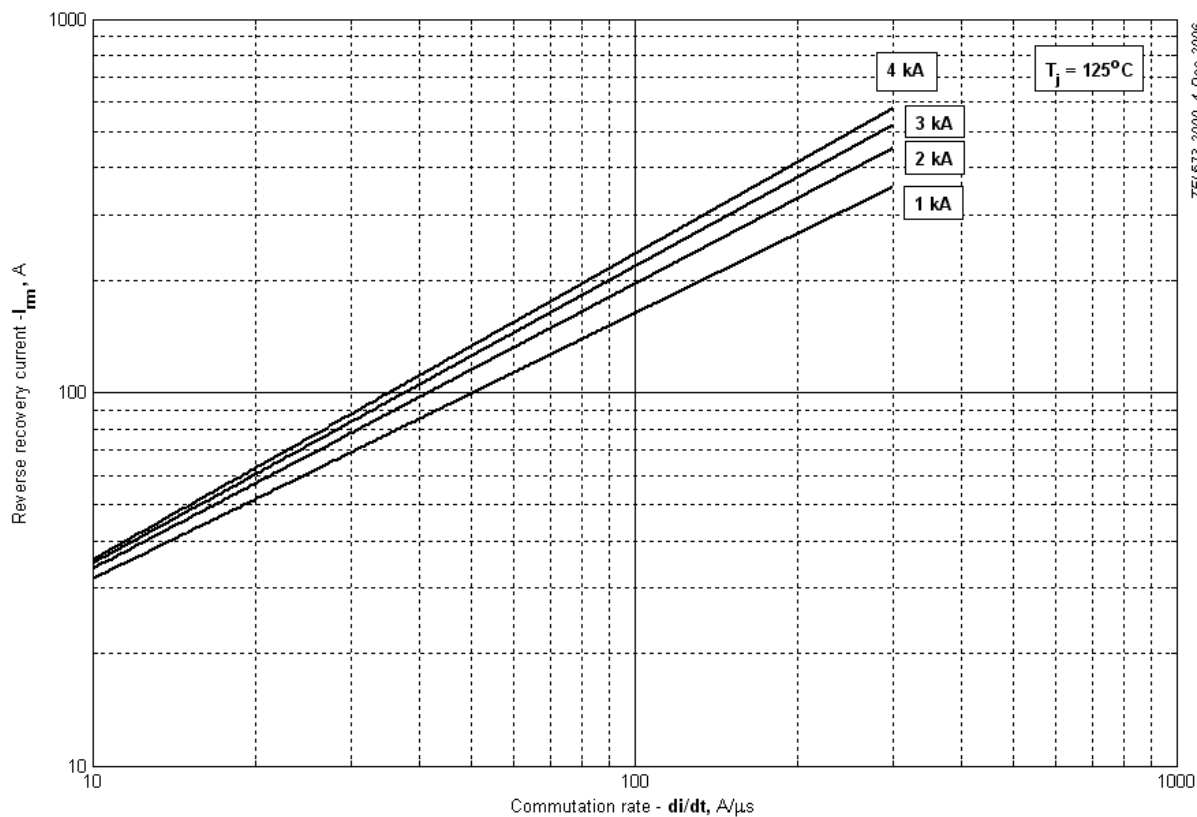


Рис. 5 – Максимальный обратный ток восстановления, I_{rr}

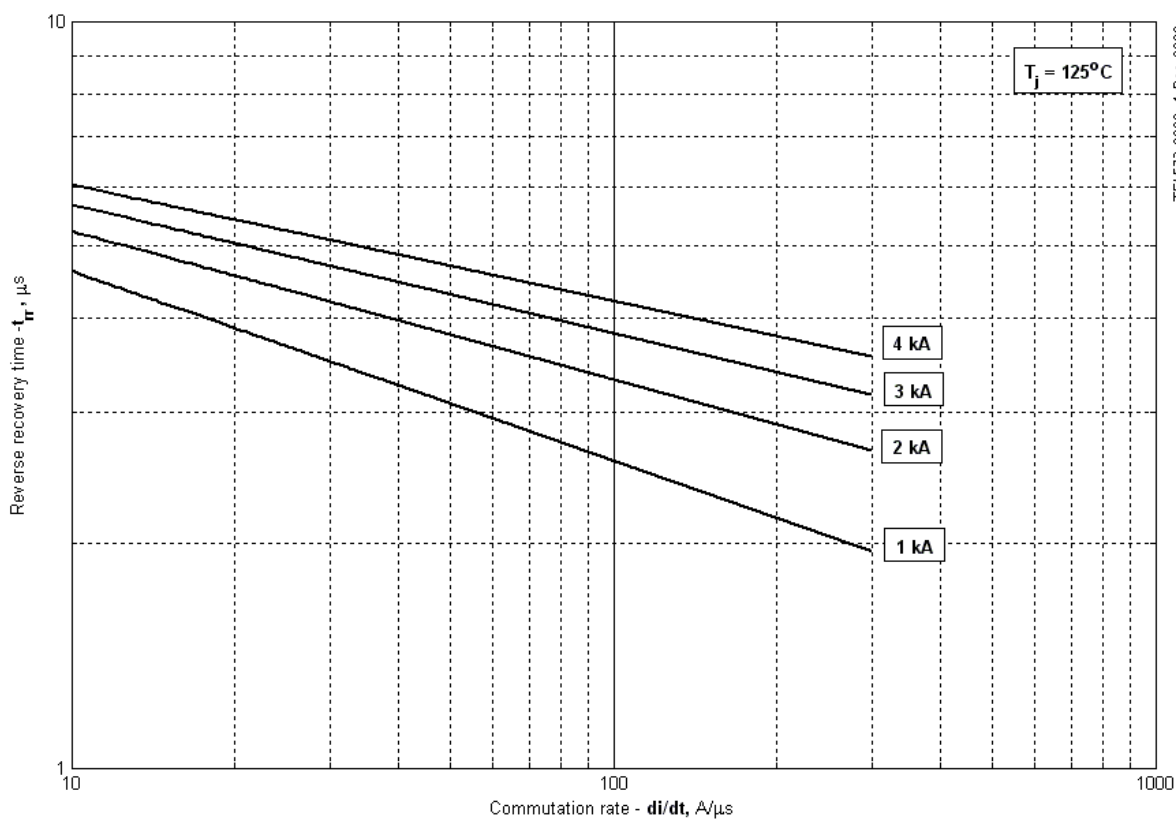


Рис. 6 – Максимальное время обратного восстановления, t_{rr} (по ГОСТ 24461, хорда 25%)

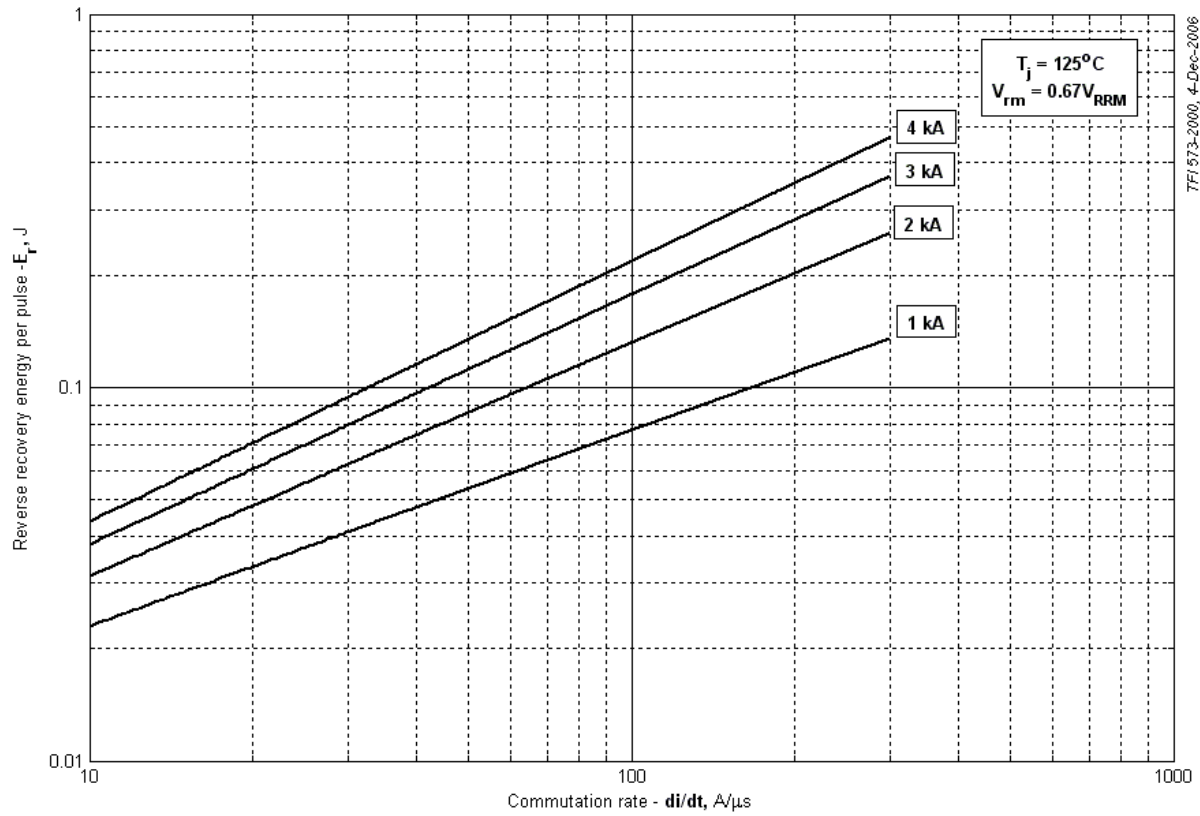


Рис. 7 – Энергия обратного восстановления за импульс

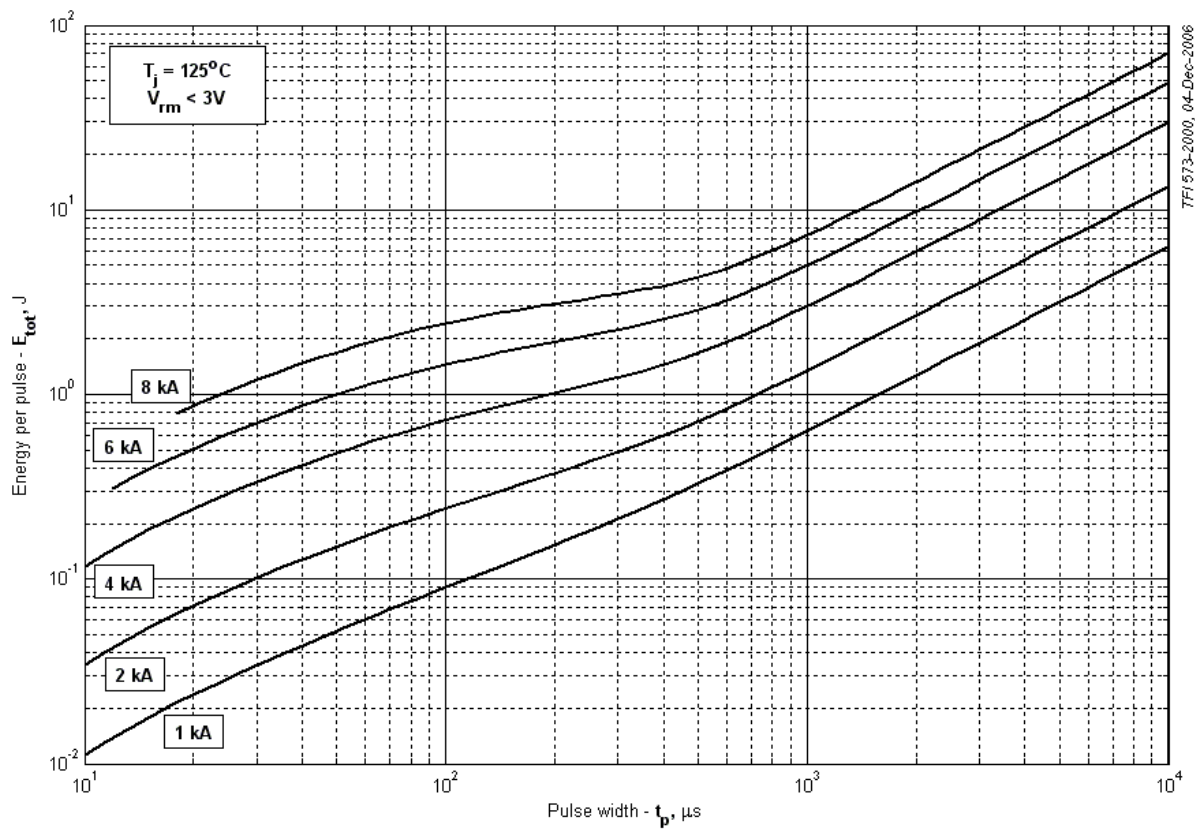


Рис. 8 – Суммарная энергия потерь одного синусоидального импульса тока

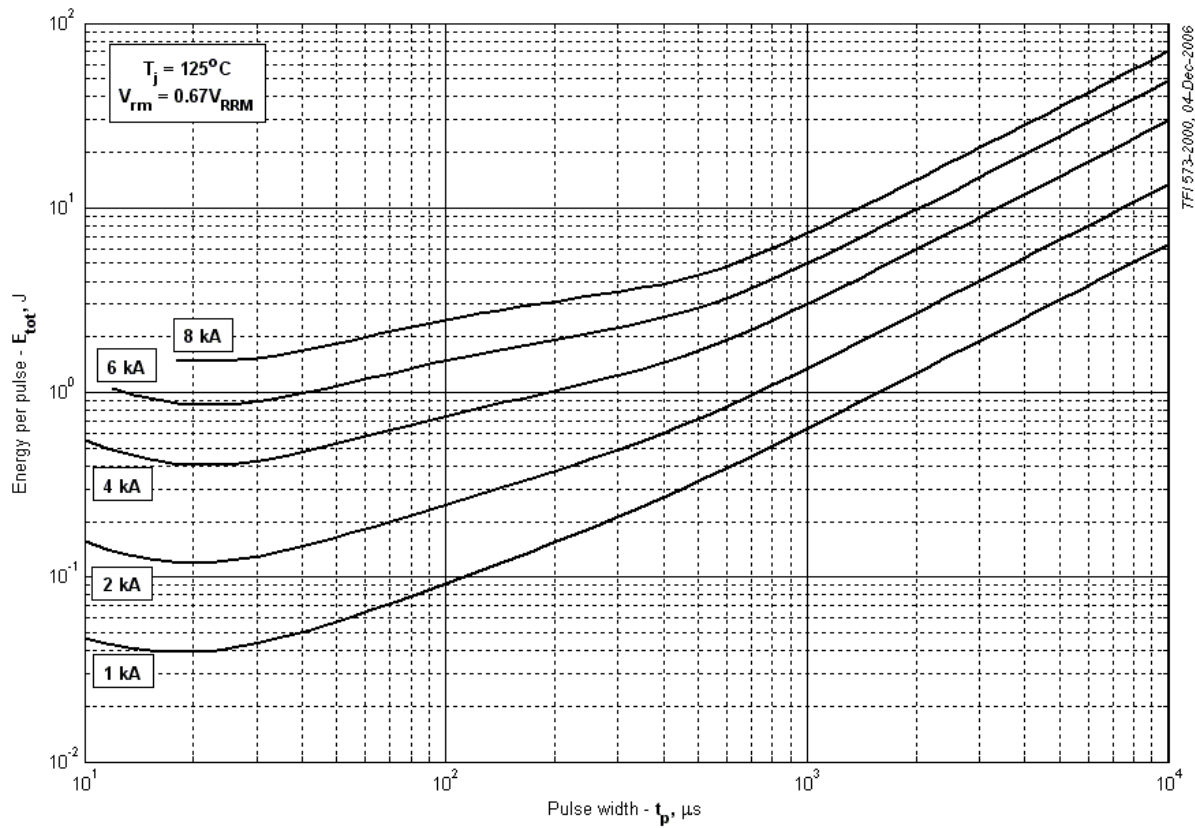


Рис. 9 – Суммарная энергия потерь одного синусоидального импульса тока

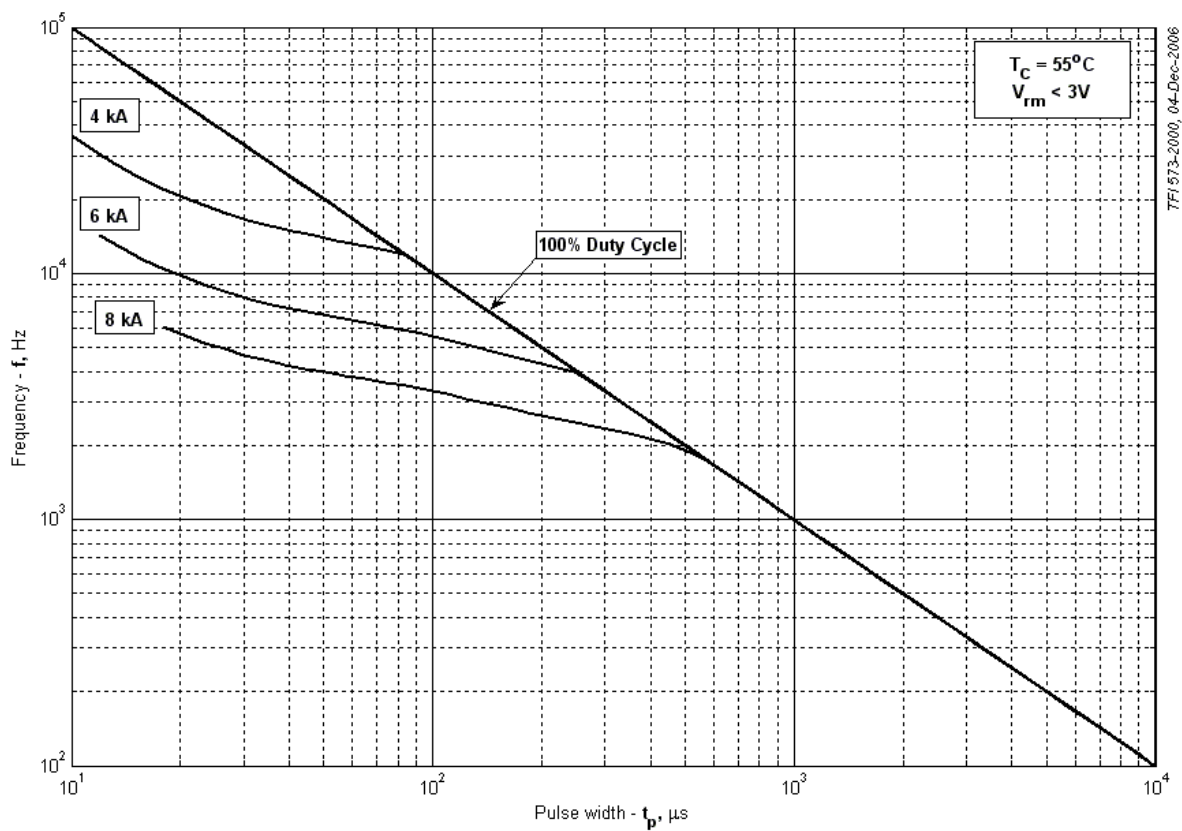


Рис. 10 – Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов

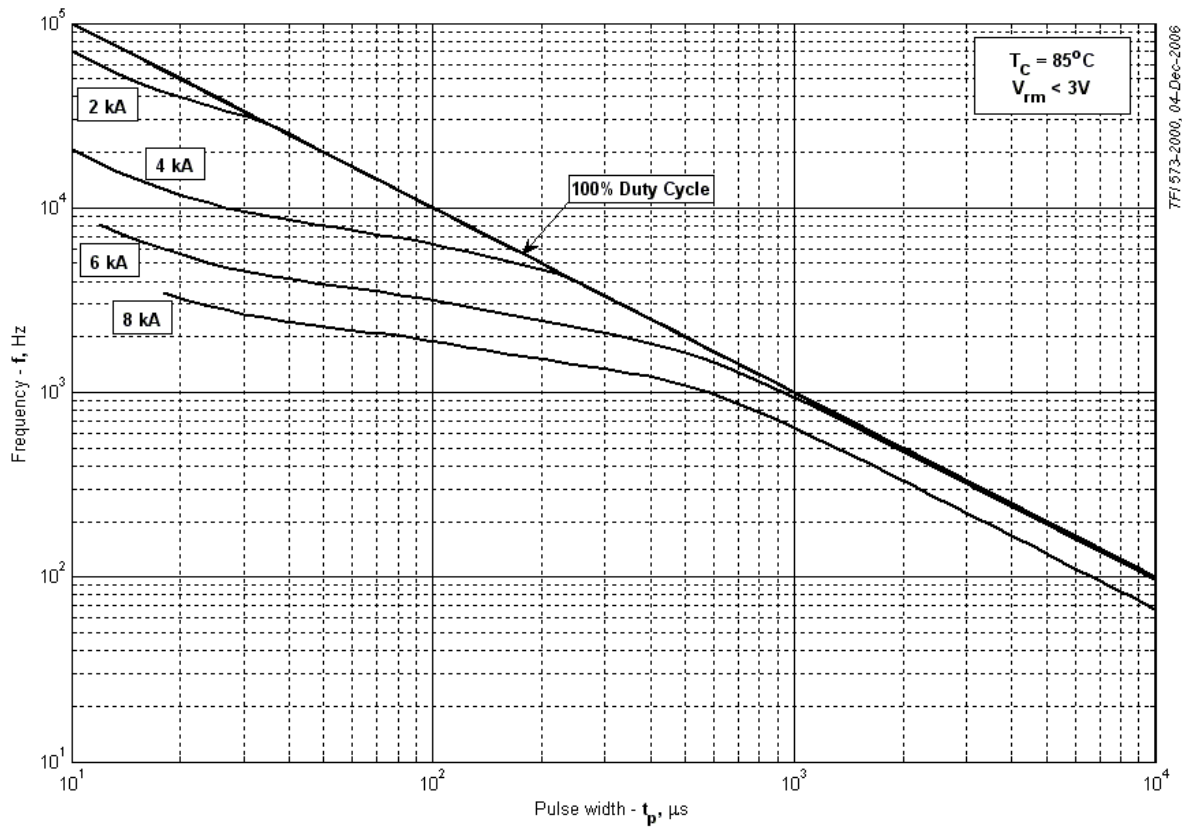


Рис. 11 – Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов

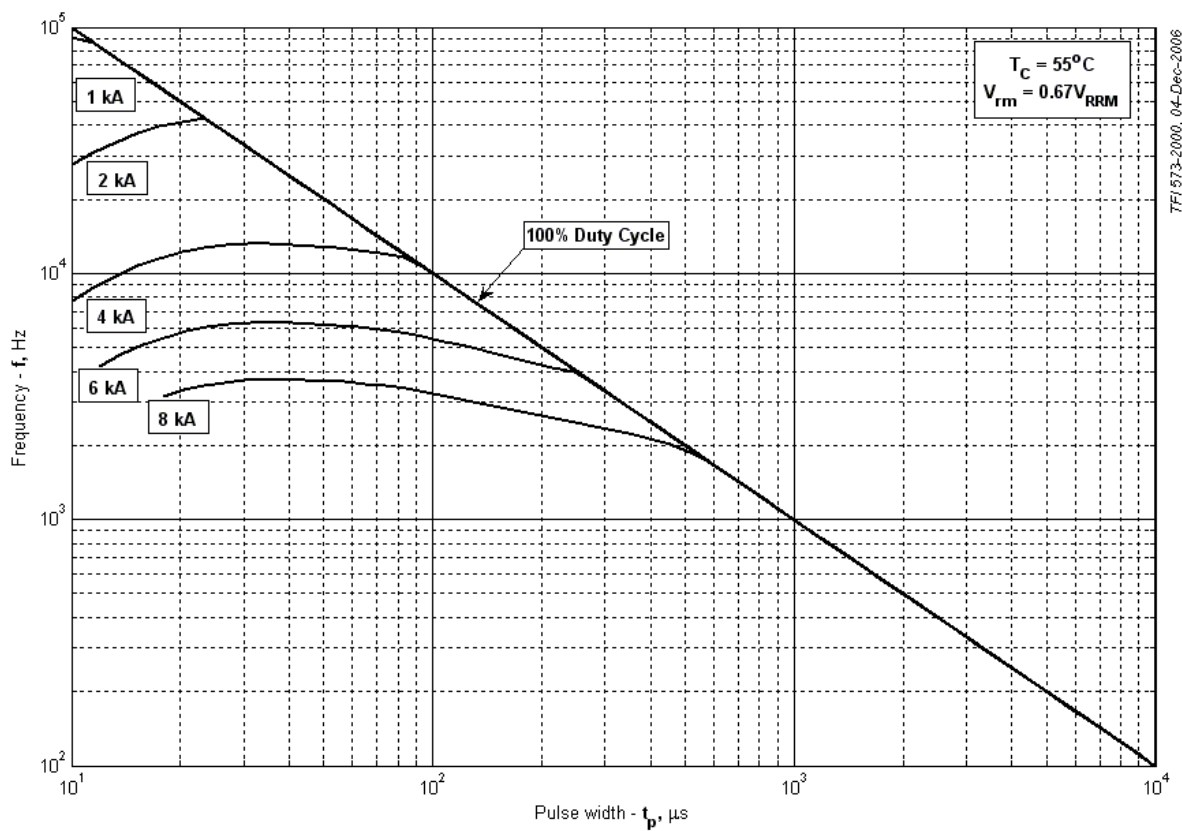
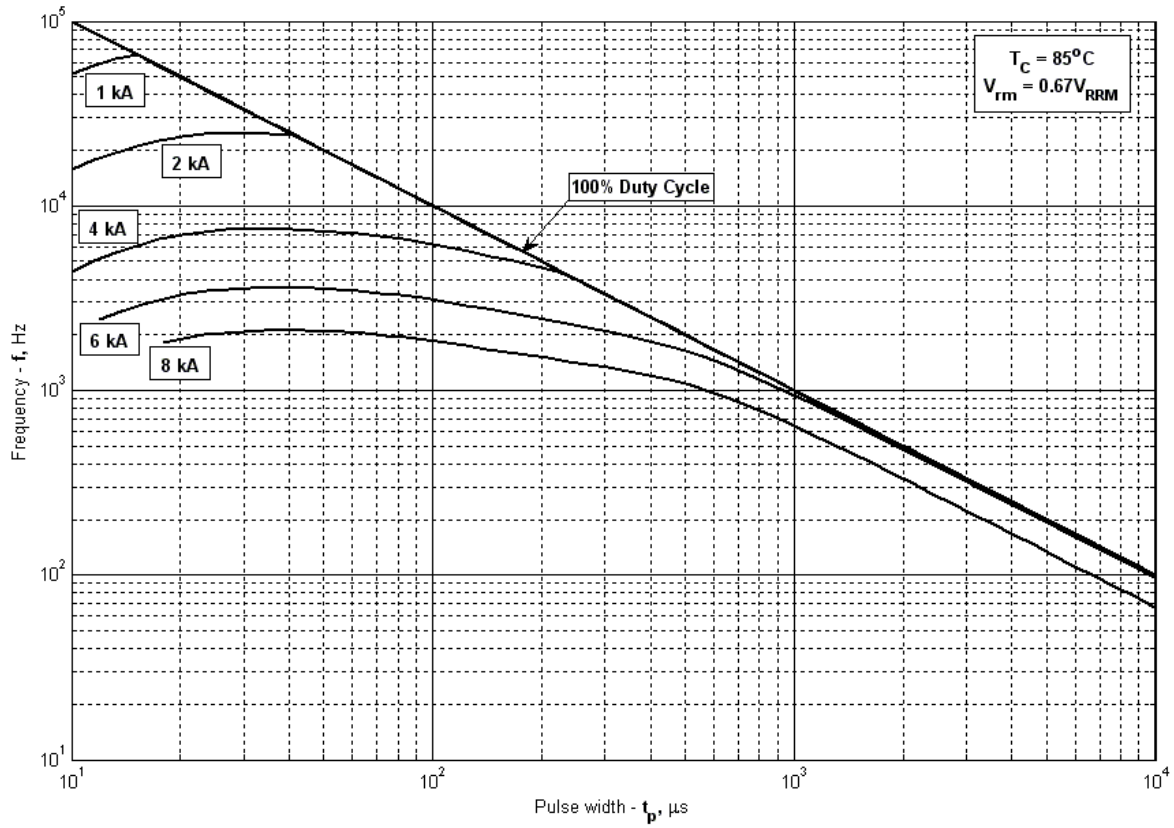
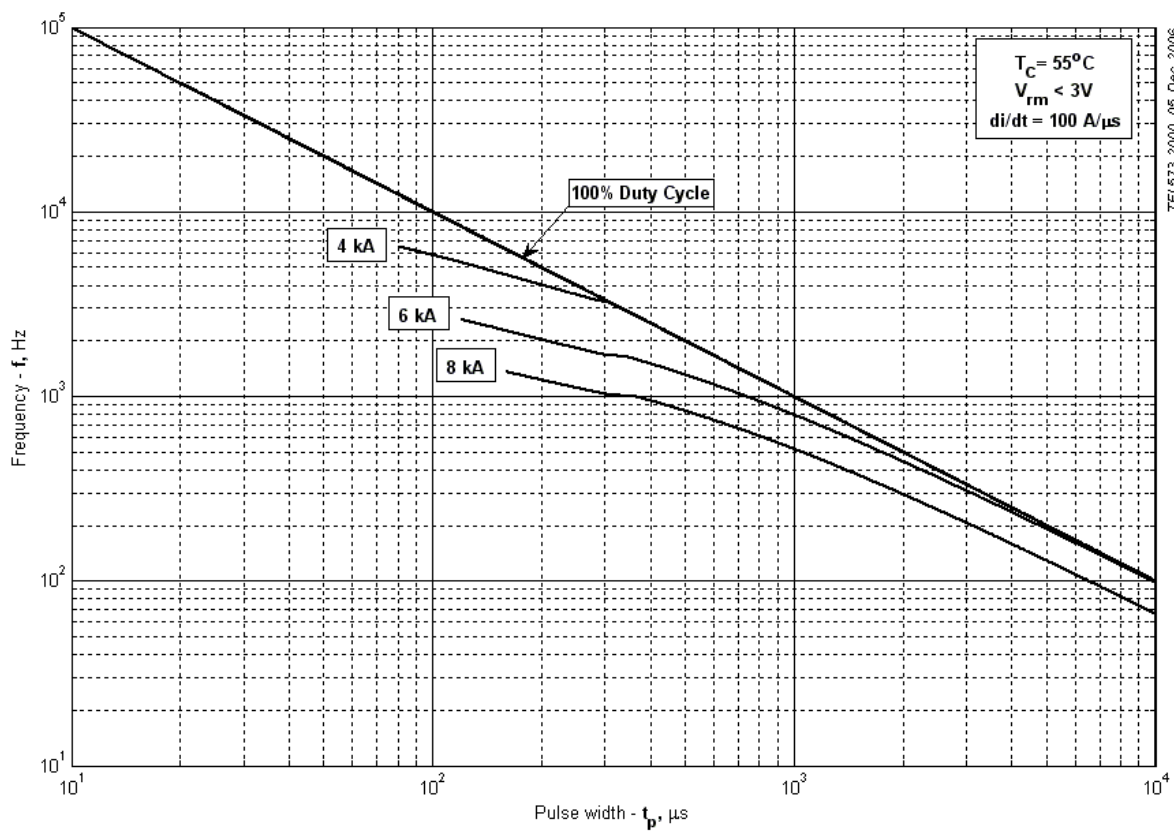


Рис. 12 – Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов



TFI573-2000, 04-Dec-2006

Рис. 13 – Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов



TFI573-2000, 05-Dec-2006

Рис. 14 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

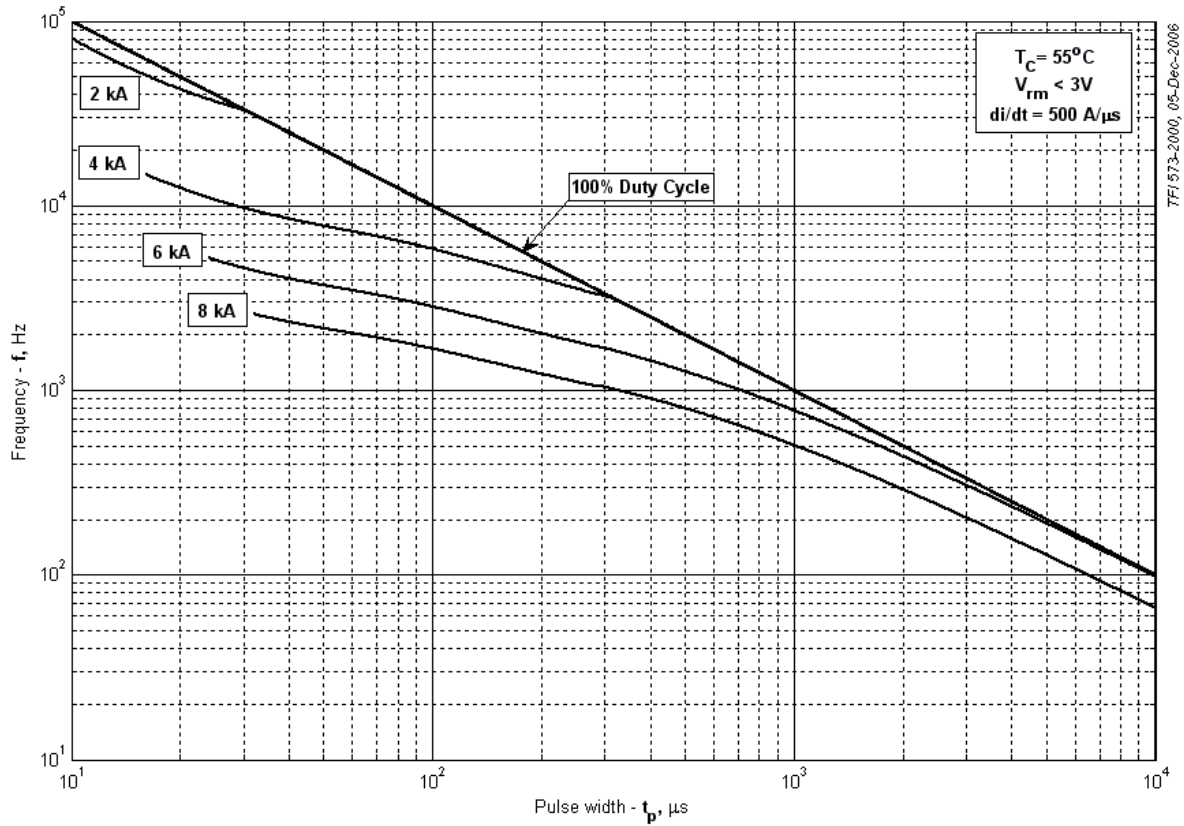


Рис. 15– Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

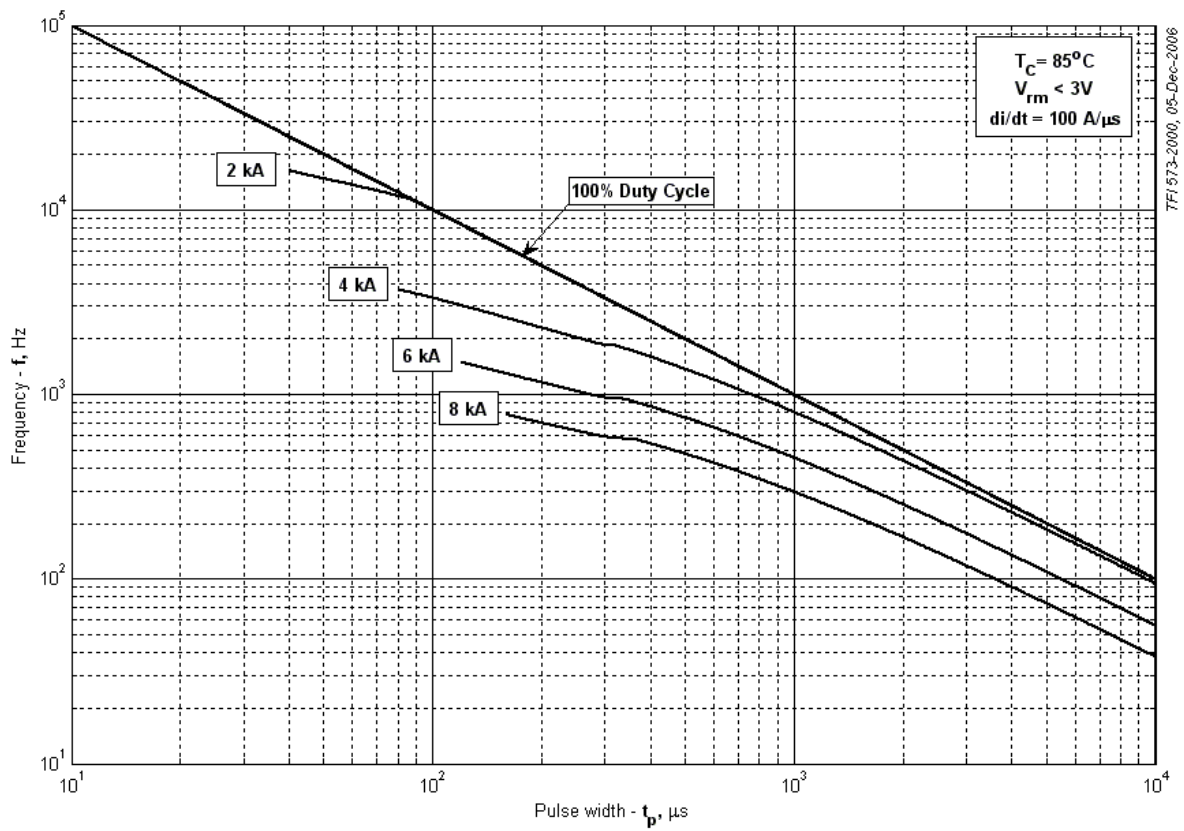


Рис. 16 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

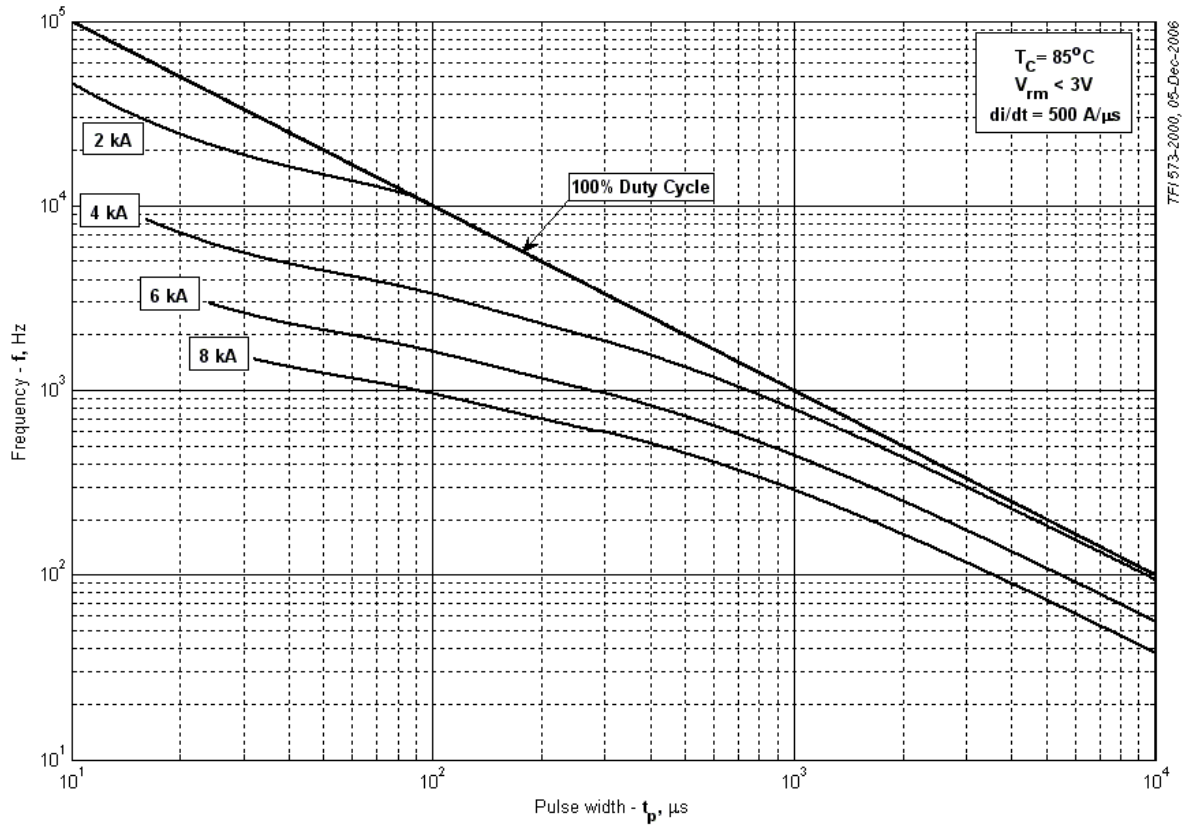


Рис. 17 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

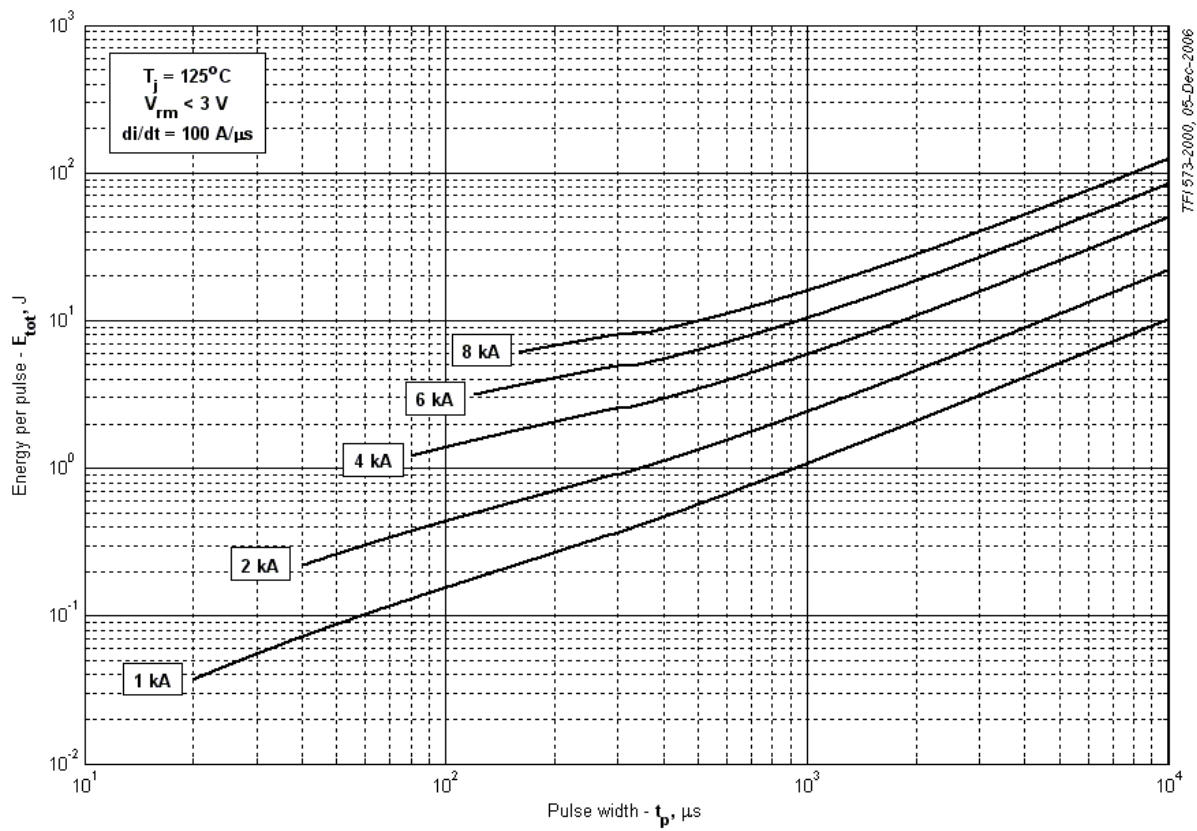


Рис. 18 – Суммарная энергия потерь одного прямоугольного импульса тока

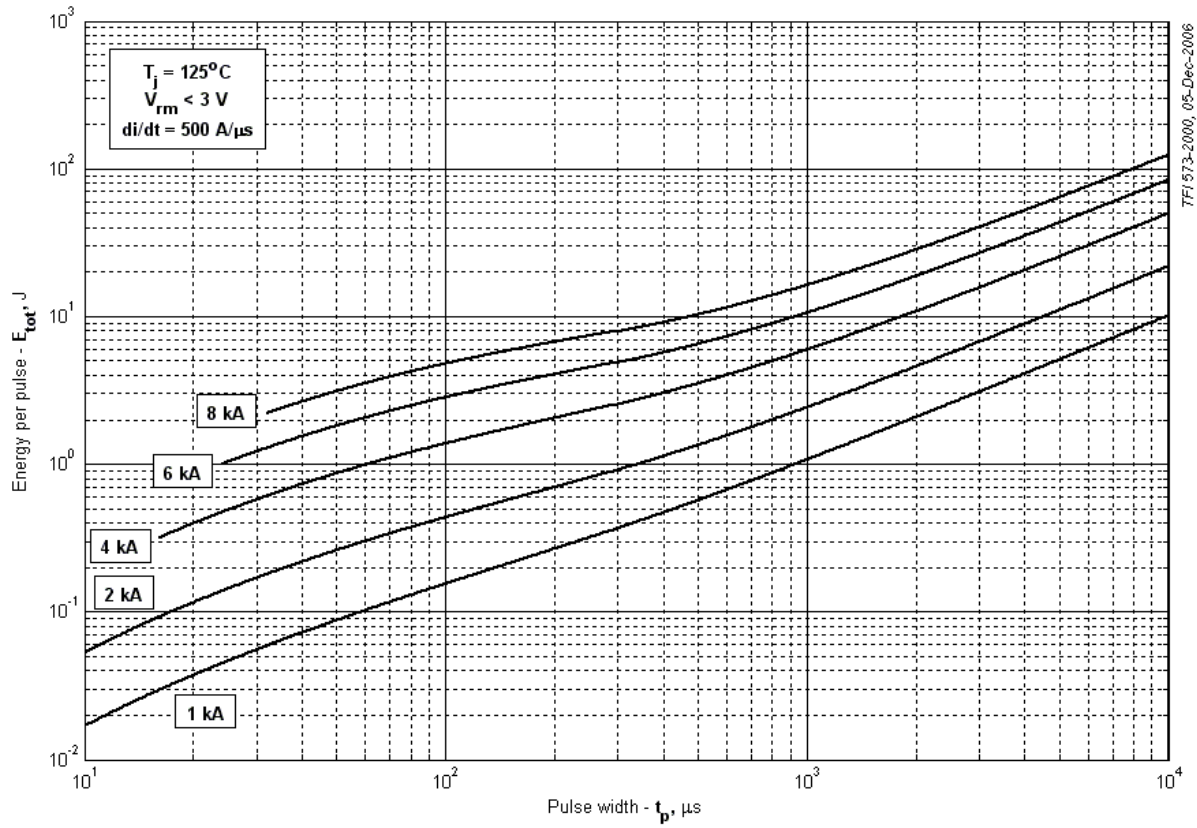


Рис. 19 – Суммарная энергия потерь одного прямоугольного импульса тока

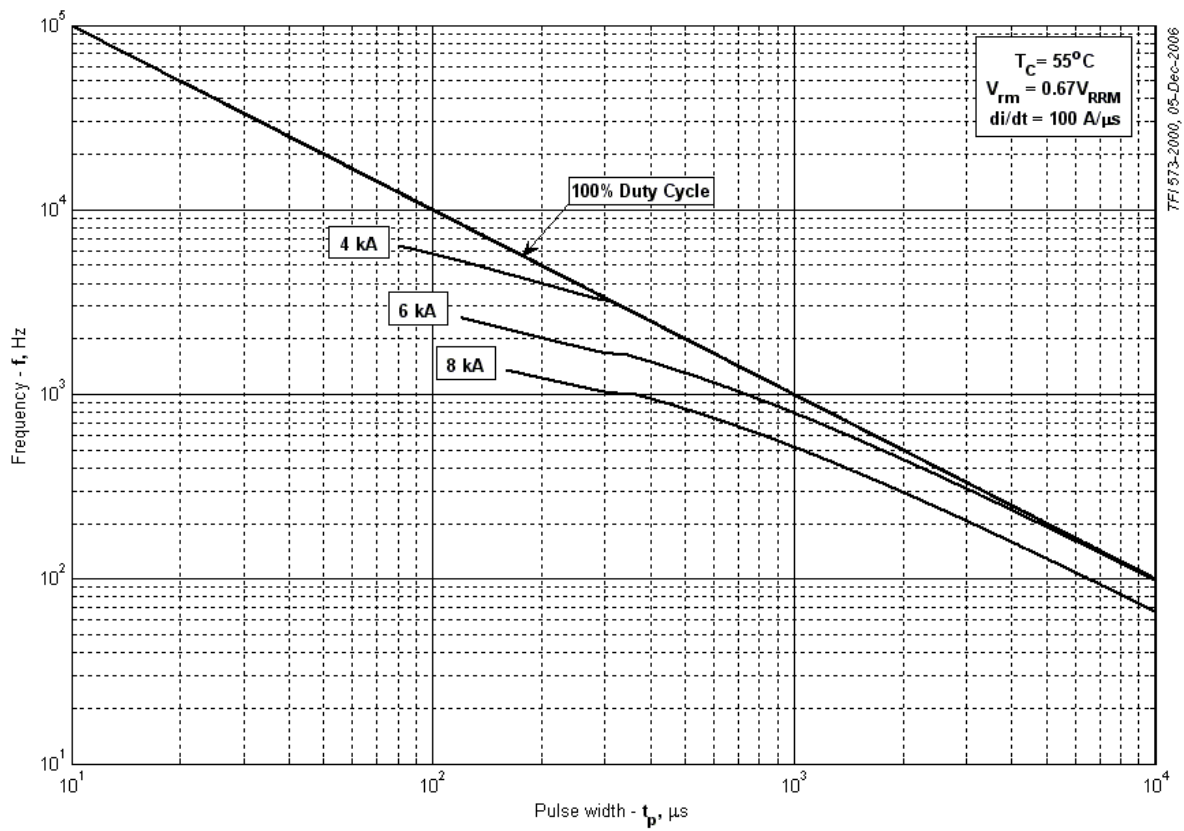


Рис. 20 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

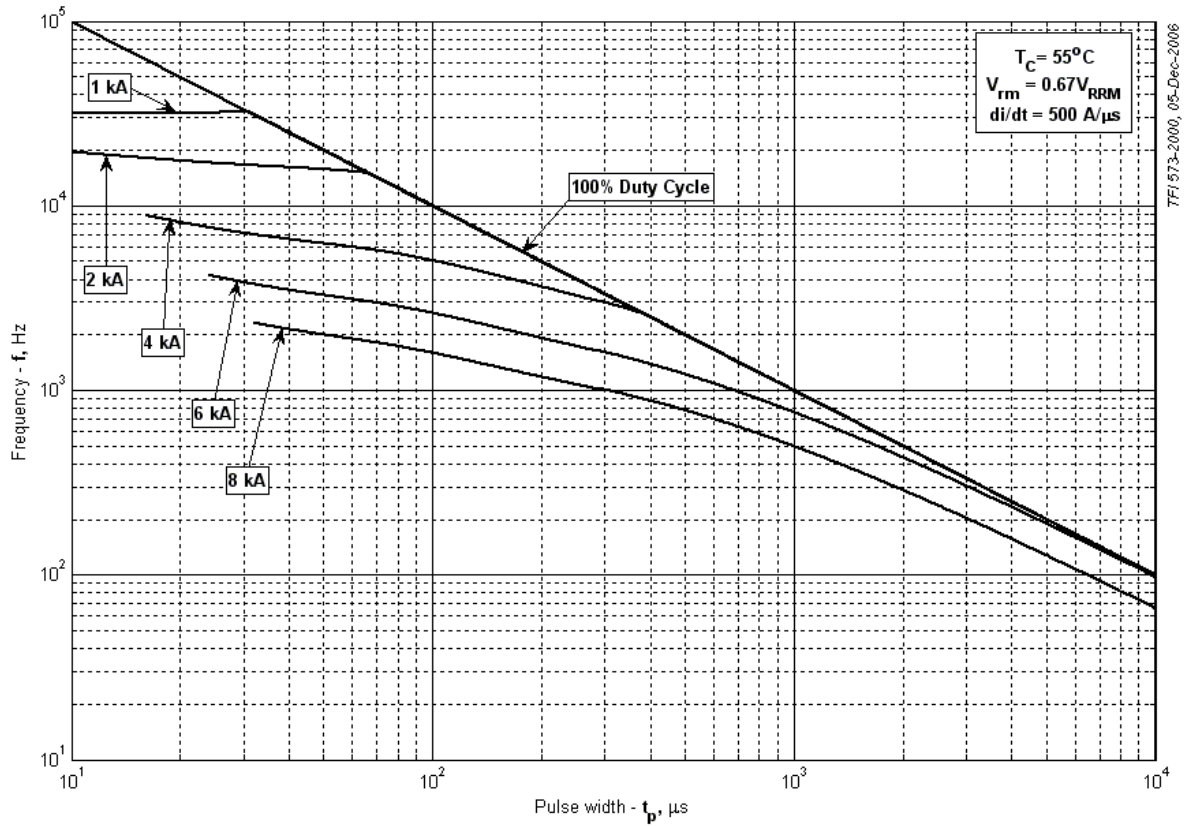


Рис. 21 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

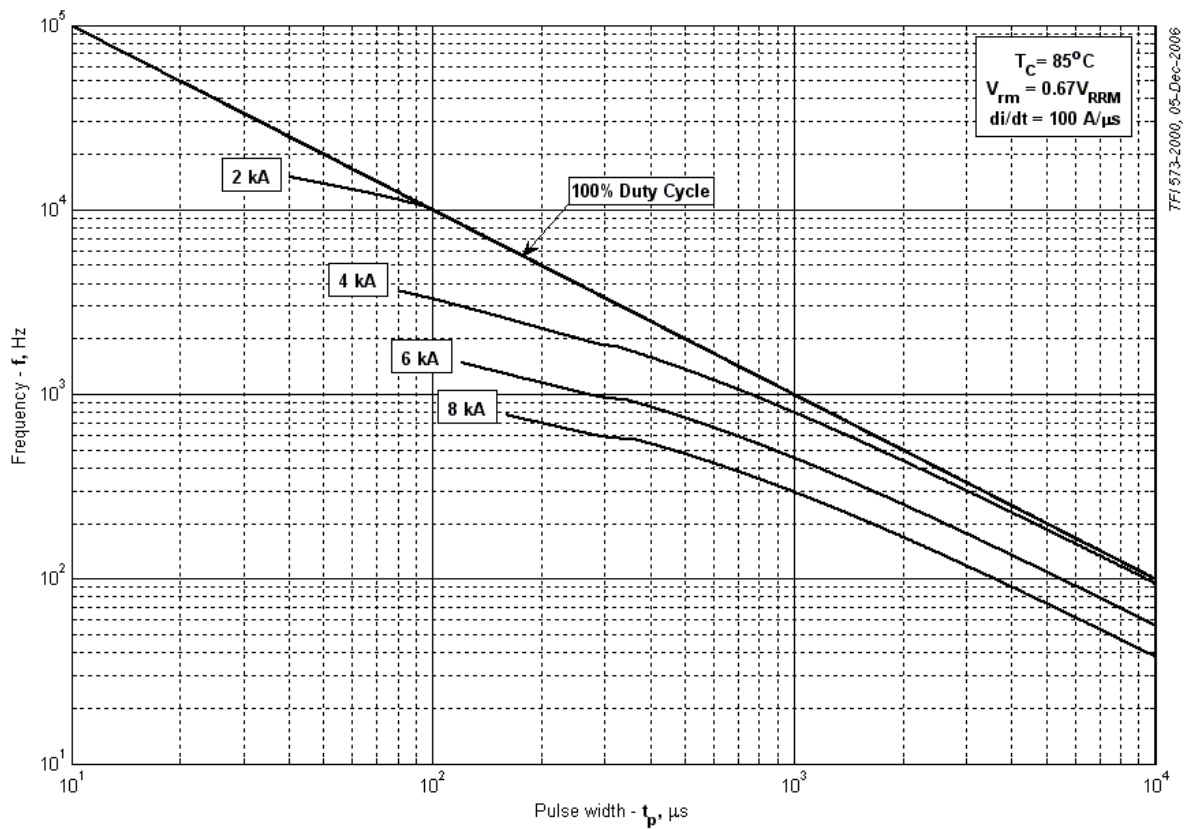


Рис. 22 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

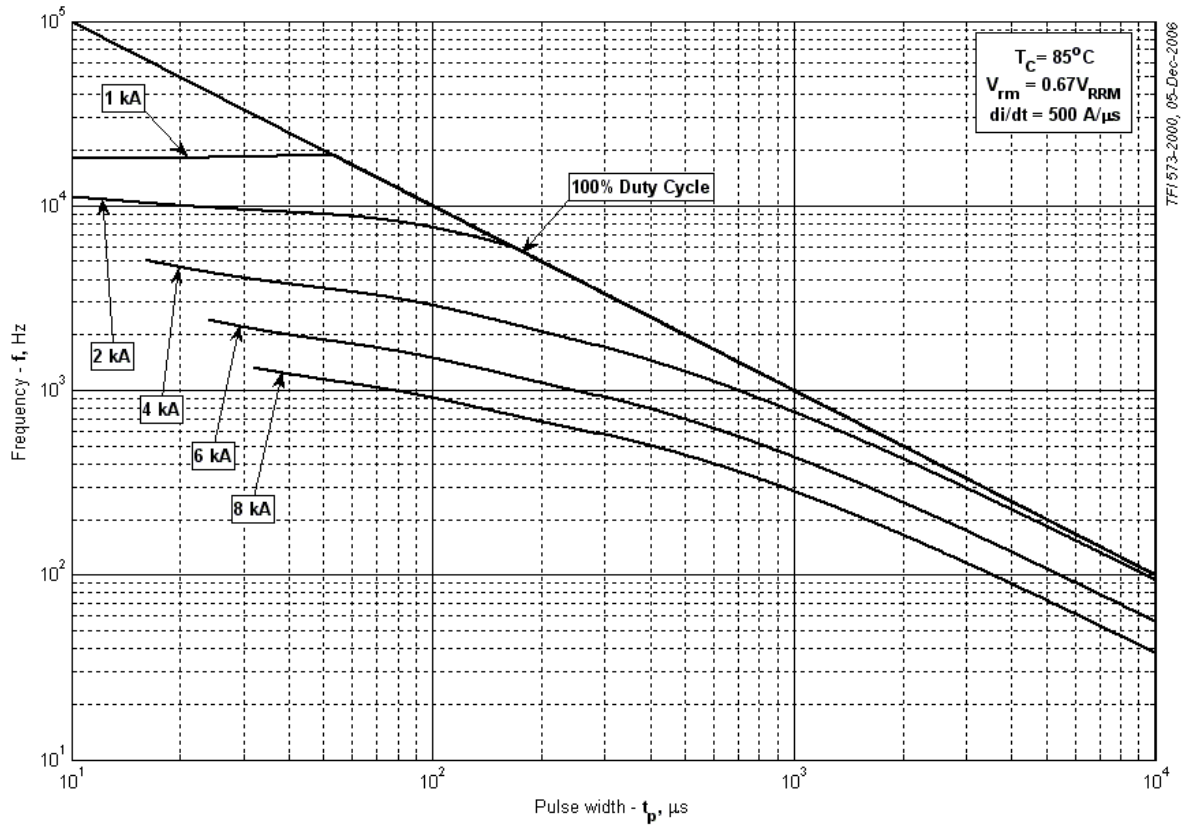


Рис. 23 – Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

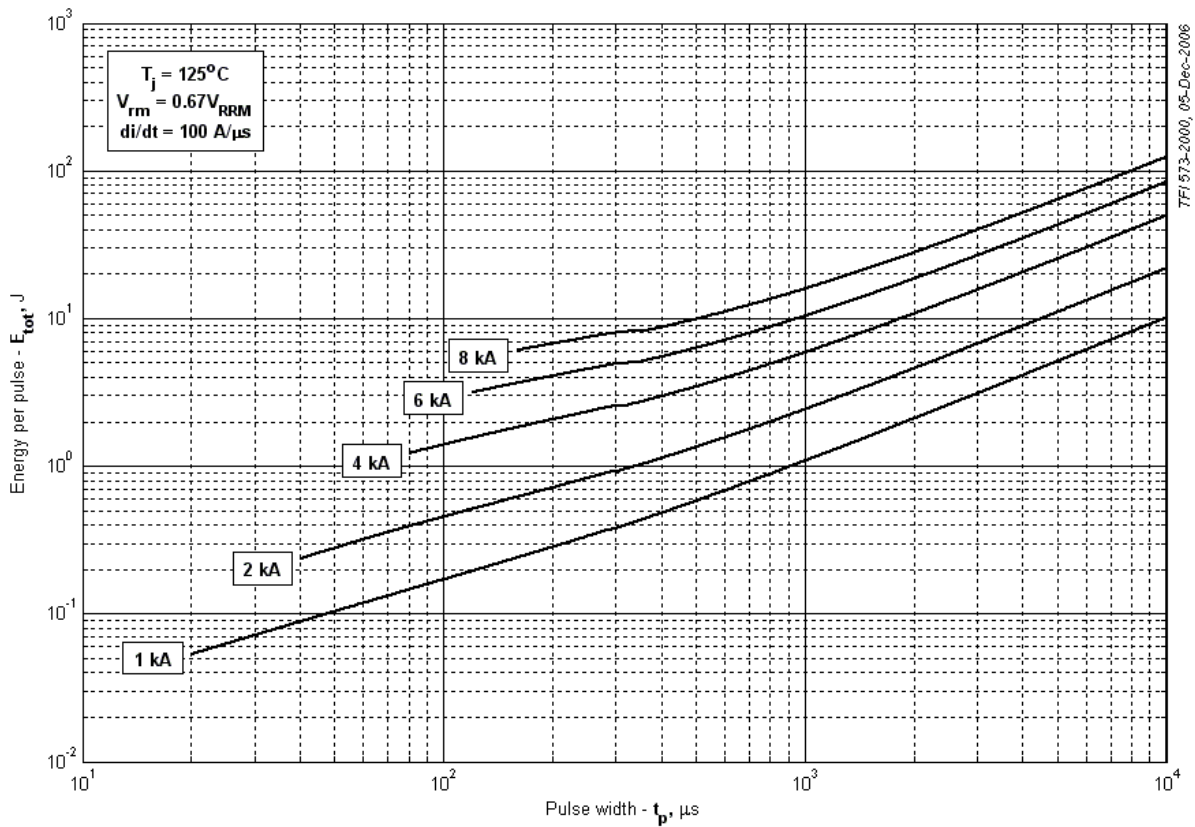


Рис. 24 – Суммарная энергия потерь одного прямоугольного импульса тока

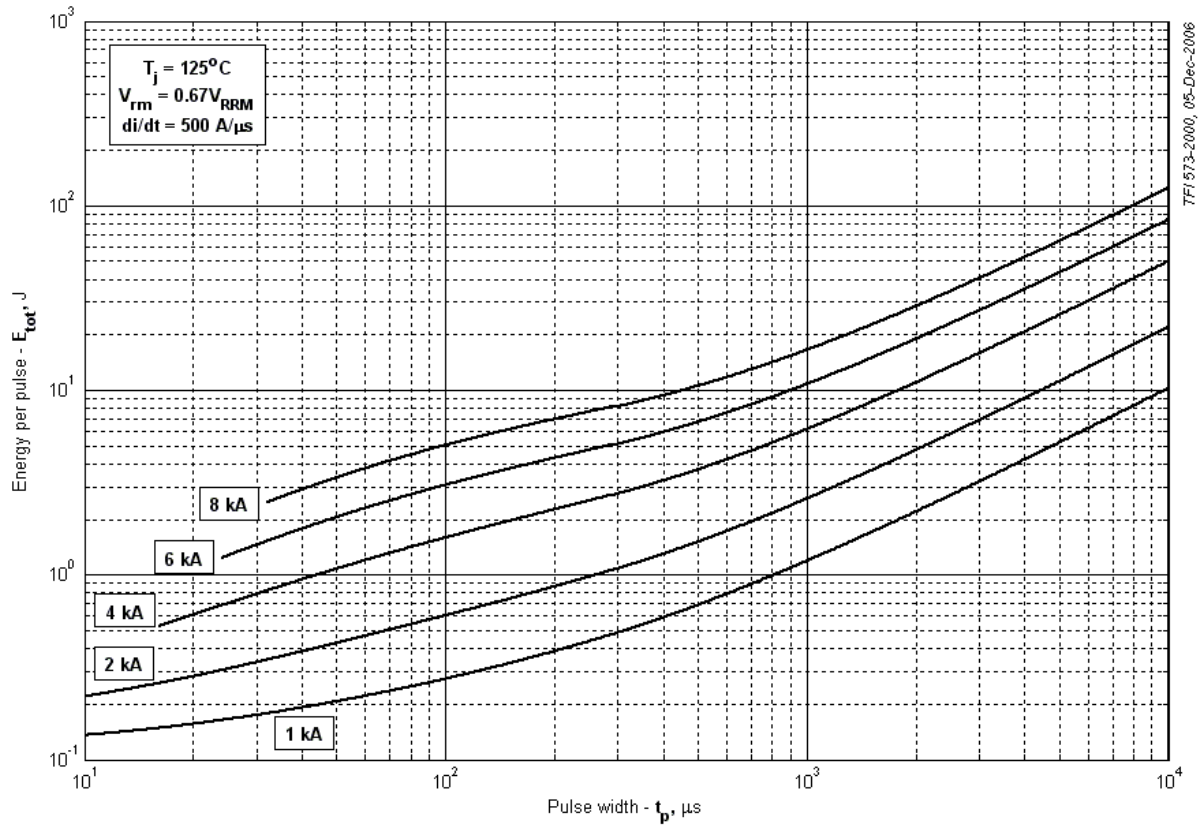


Рис. 25 – Суммарная энергия потерь одного прямоугольного импульса тока

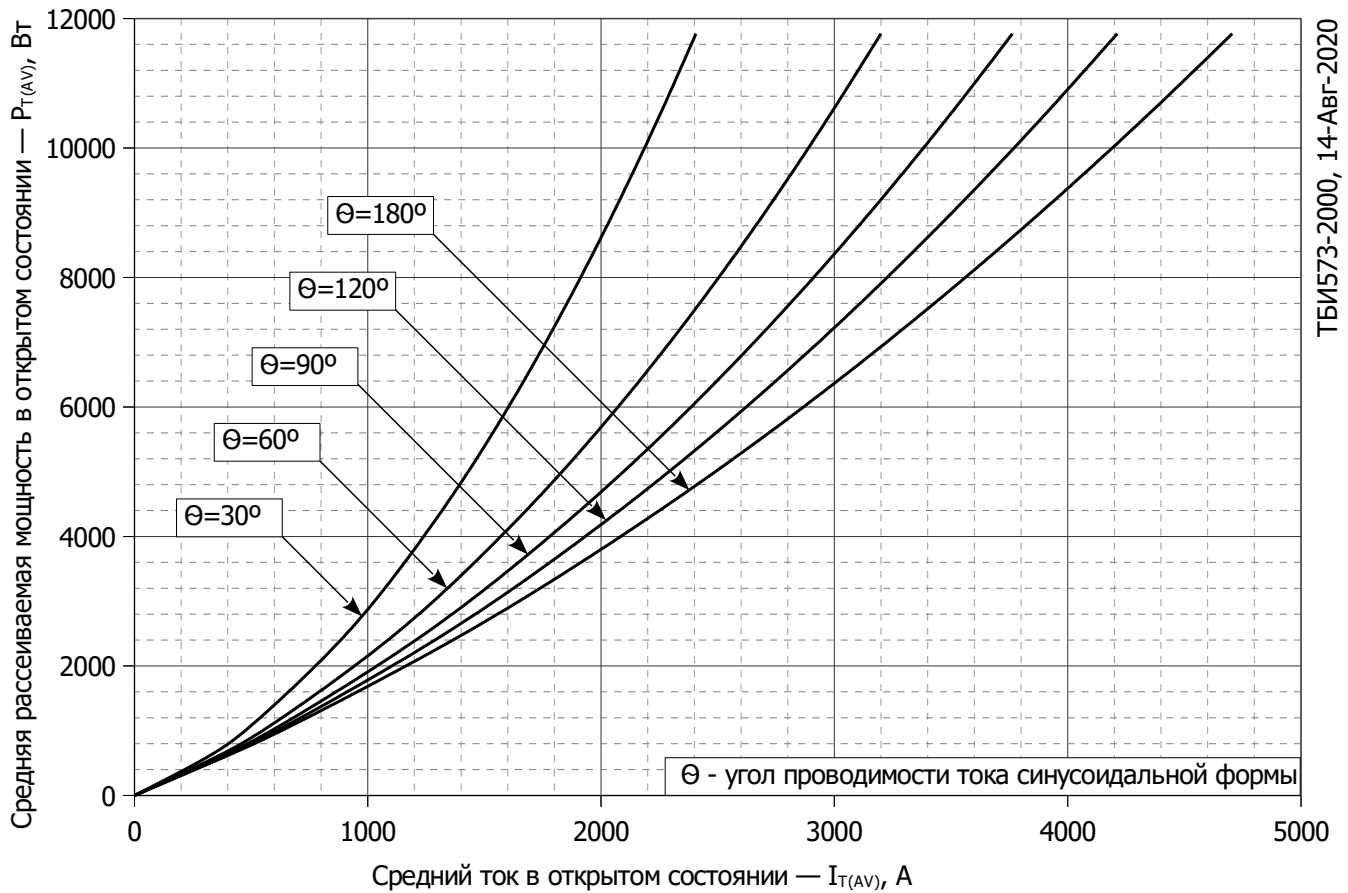


Рис. 26 - Зависимость потерь мощности P_{TAV} от среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} синусоидальной формы при различных углах проводимости ($f=50$ Гц, двухстороннее охлаждение)

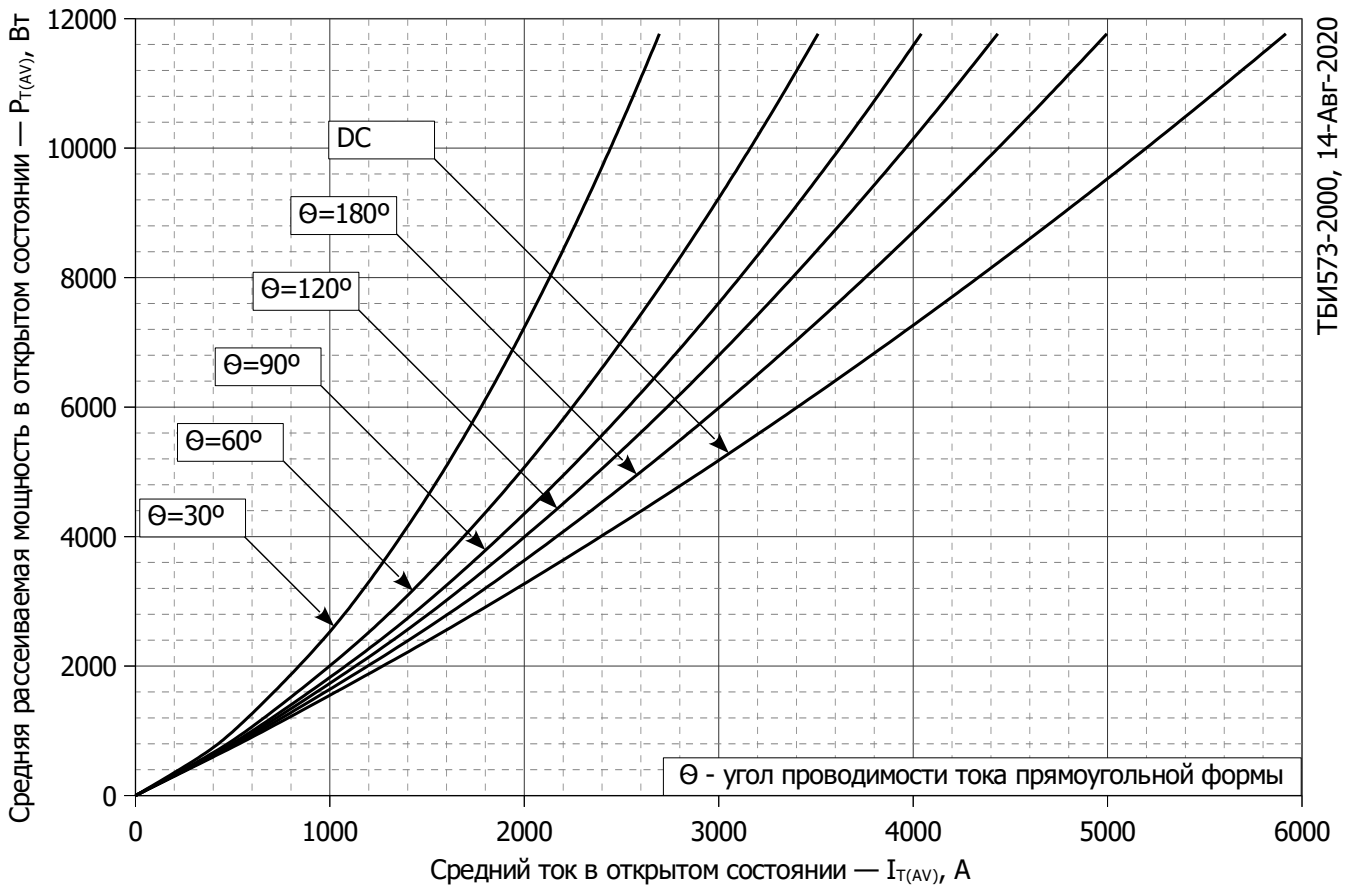


Рис. 27 – Зависимость потерь мощности P_{TAV} от среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} прямоугольной формы при различных углах проводимости ($f=50$ Гц, двухстороннее охлаждение)

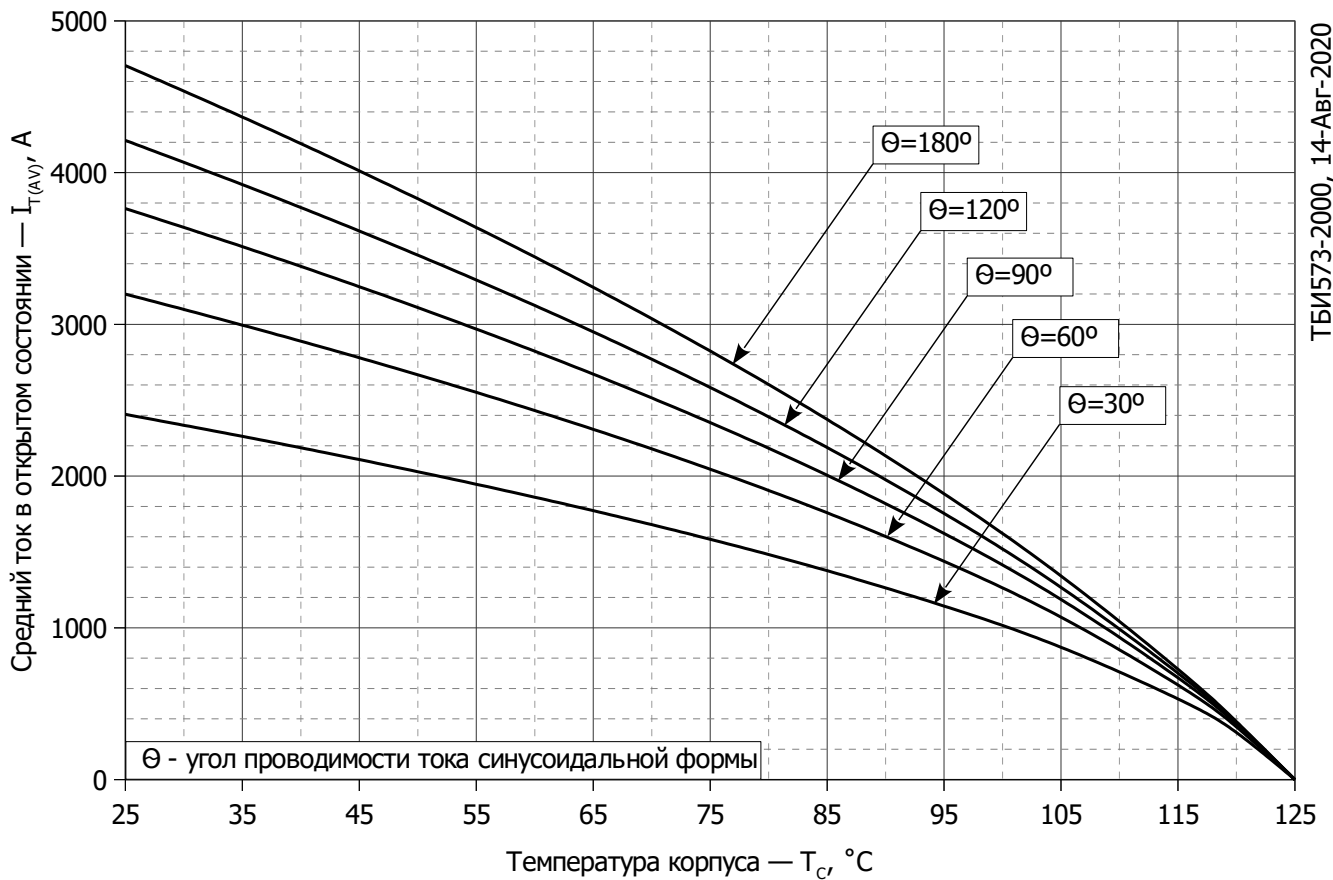


Рис. 28 – Зависимость среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} от температуры корпуса T_c для синусоидальной формы тока при различных углах проводимости ($f=50$ Гц, двухстороннее охлаждение)

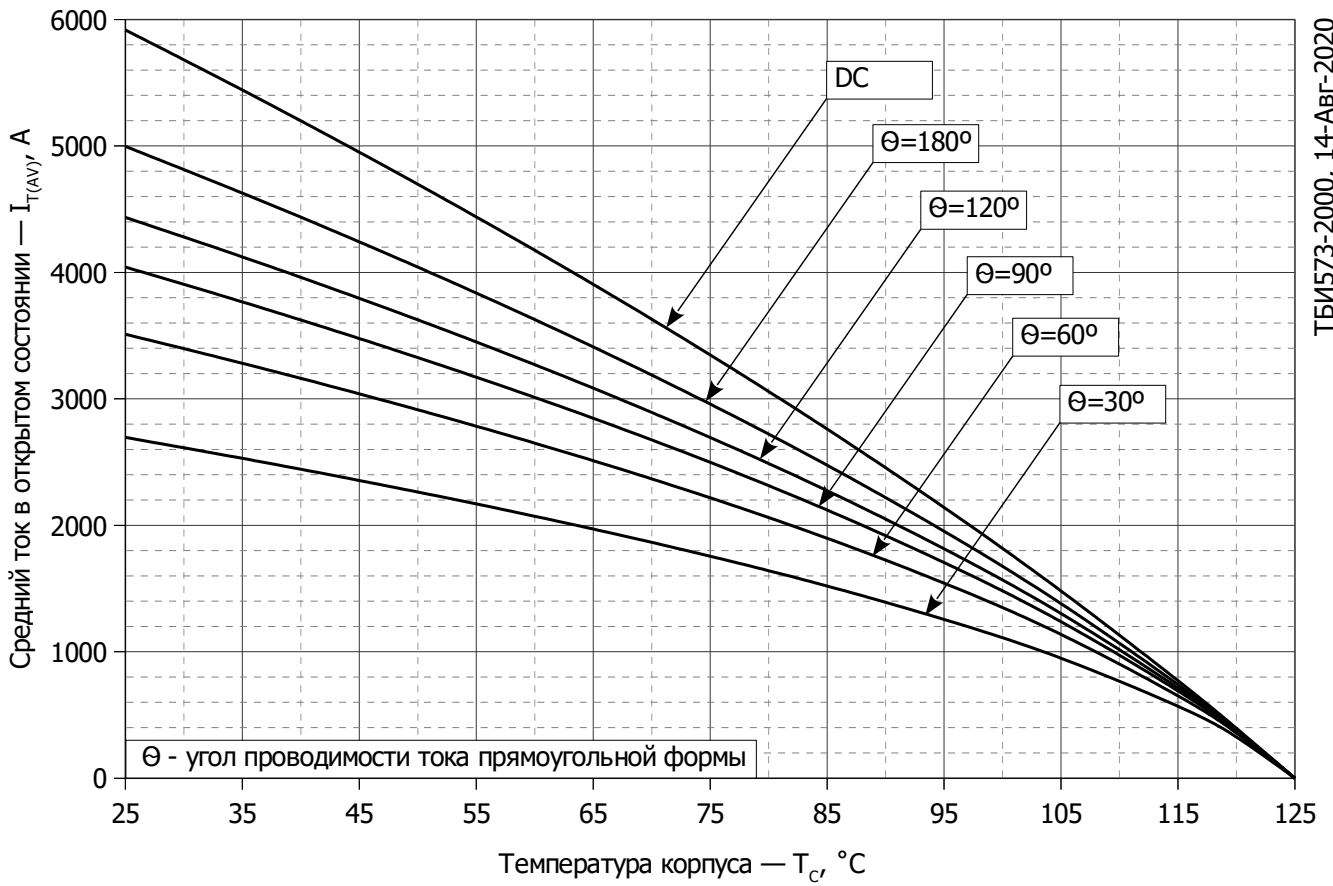


Рис. 29 - Зависимость среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} от температуры корпуса T_C для прямоугольной формы тока при различных углах проводимости ($f=50$ Гц, двухстороннее охлаждение)

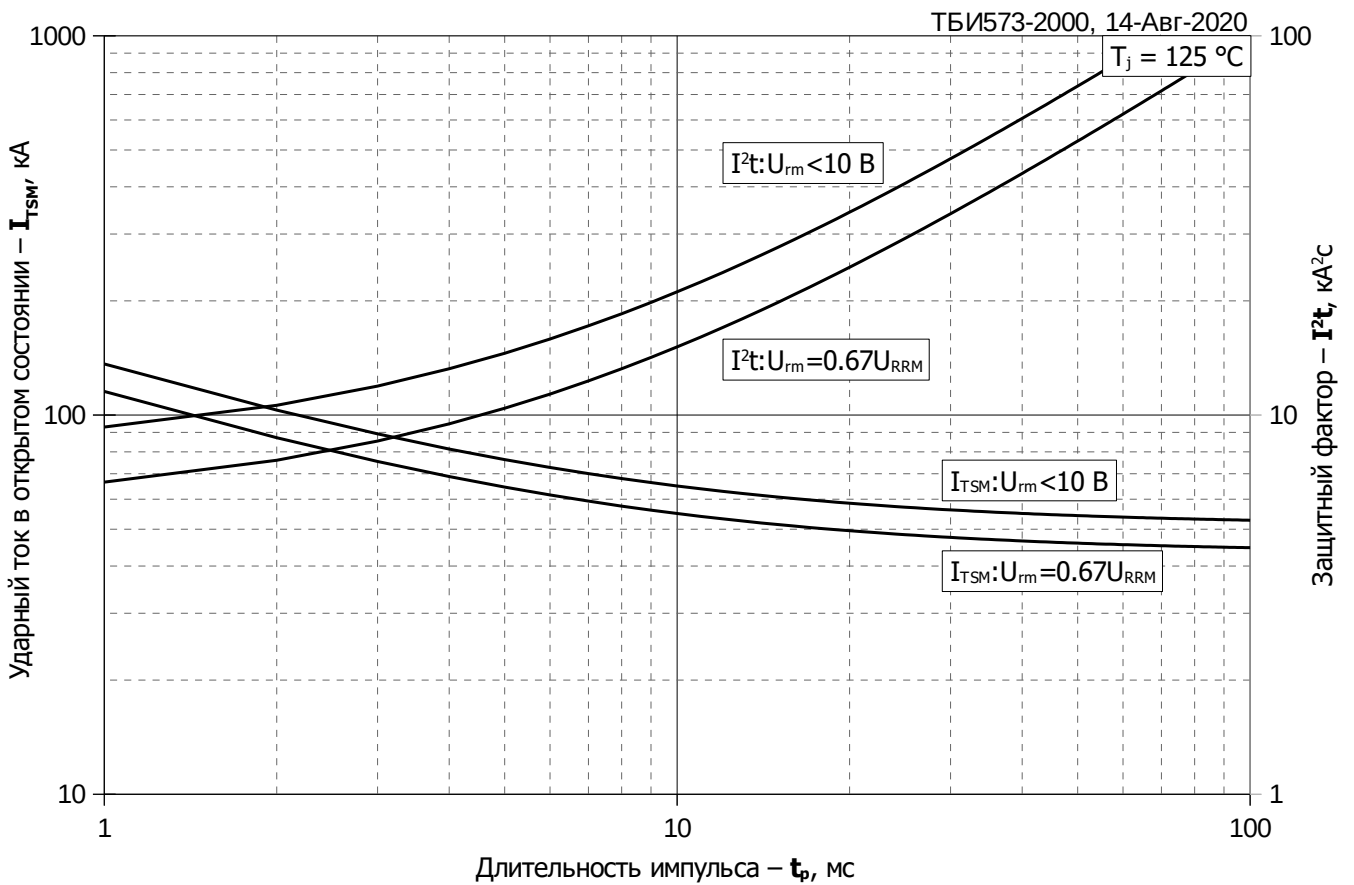


Рис. 30 – Максимальные ударные и I^2t характеристики

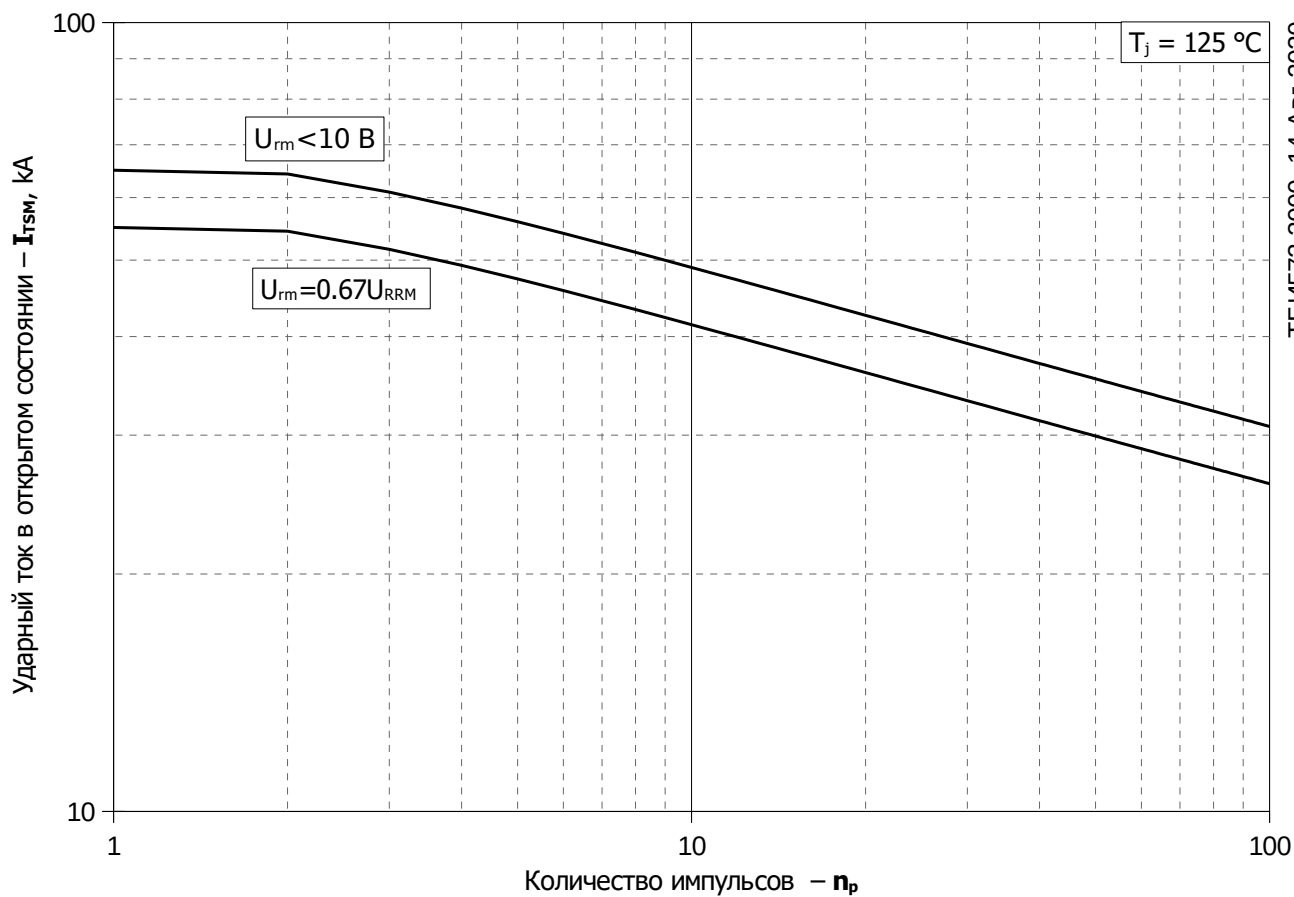


Рис. 31 – Зависимость допустимой амплитуды ударного тока от числа импульсов